PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-177537

(43) Date of publication of application: 27.06.2003

(51)Int.CI.

G03F 7/039 CO8F 12/14 H01L 21/027

(21)Application number : 2002-060583

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

06.03.2002

(72)Inventor: MIZUTANI KAZUYOSHI

YASUNAMI SHOICHIRO

SHIRAKAWA KOJI TAKAHASHI AKIRA **FUJIMORI TORU**

(30)Priority

Priority number : 2001305364

Priority date: 01.10.2001

Priority country: JP

(54) POSITIVE RESIST COMPOSITION FOR ELECTRON BEAM, X-RAY OR EUV (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a positive resist composition which improves the profile of a resist pattern and suppresses a variation of line width due to laying in a vacuum chamber.

SOLUTION: The positive resist composition for an electron beam, X-rays or EUV (extreme-ultraviolet radiation) comprises (a) a resin which has a structural unit containing an acid-decomposable group of formula (X) and is decomposed by the action of an acid to increase solubility in an alkali developer and (b) a compound which generates an acid upon irradiation with an actinic radiation. In formula (X), R1 and R2 may be the same or different and are each H or a 1-4C alkyl; W is a divalent organic group; and R3 is an alkyl which may have substituents and has 11-20 carbon atoms in total, an aryl which may have substituents and has 11-30 carbon atoms in total or an aralkyl which may have substituents and has 12-30 carbon atoms in total.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

14.05.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

BEST AVAILABLE COPY

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-177537

(P2003-177537A)

(43)公開日 平成15年6月27日(2003.6.27)

(51) Int.CL'		隙別記号	FI		テーマコート*(参考)		
G03F	7/039	601	G03F	7/039	601	2H025	
C08F	12/14		C 0 8 F	12/14		4J100	
H01L	21/027		H01L	21/30	502R		

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全123頁)

		10000000000000000000000000000000000000	不明不 明不识以致 1 〇〇 (主 1 2 人)
(21)出願番号	特顧2002-60583(P2002-60583)	(71)出顧人	000005201
	•		富士写真フイルム株式会社
(22)出顧日	平成14年3月6日(2002.3.6)		神奈川県南足柄市中沼210番地
		(72)発明者	水谷 一良
(31)優先権主張番号	特願2001-305364(P2001-305364)		静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写
(32) 任先日	平成13年10月1日(2001.10.1)		真フイルム株式会社内
(33) 優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者	
		(-) 5) 1 -	静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写
			真フイルム株式会社内
		(74)代理人	
		(14/14/42/)	弁理士 小栗 昌平 (外4名)
			开理工 小来 自干 (F4石)

最終質に続く

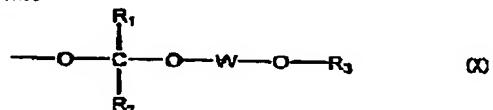
(54) 【発明の名称】 ポジ型電子線、X線又はEUV用レジスト組成物

(57)【要約】

(修正有)

【課題】 レジストパターンプロファイル、真空チャンバー内での引き置きによる線幅変動が改善されたポジ型レジスト組成物が提供すること。

【解決手段】 (a)下記一般式(X)の酸分解性基を含有する構造単位を有し、酸の作用により分解してアルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂、及び(b)活性放射線の照射により酸を発生する化合物を含有することを特徴とするポジ型電子線、X線又はEUV用レジスト組成物。



式(X)中、R₁、R₂は、同一でも異なっていてもよく、水素原子、炭素数 1~4のアルキル基を表し、Wは 2価の有機基を表し、R₃は総炭素数 1 1~20の置換基を有してもよいアルキル基、総炭素数 1 1~30の置換基を有してもよいアリール基、総炭素数 1 2~30の置換基を有してもよいアラルキル基を表す。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (a)下記一般式(X)で示される基を含有する構造単位を有し、酸の作用により分解してアルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂、及び(b)活性放射線の照射により酸を発生する化合物を含有することを特徴とするポジ型電子線、X線又はEUV用レジスト組成物。

1

【化1】

式(X)中、R₁、R₂は、同一でも異なっていてもよく、水素原子、炭素数1~4のアルキル基を表し、Wは2価の有機基を表し、R₃は総炭素数11~20の置換基を有してもよいアルキル基、総炭素数11~30の置換基を有してもよいアリール基、総炭素数12~30の置換基を有してもよいアリール基、総炭素数12~30の置換基を有してもよいアラルキル基を表す。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体集積回路素子、集積回路製造用マスク等の製造に用いるポジ型レジスト組成物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】ポジ型フォトレジスト組成物として、米国特許第4,491,6 28号明細書、欧州特許第29,139号明細書等に記載されている化学増幅系レジスト組成物がある。化学増幅型ポジレジスト組成物は、遠紫外光等の放射線の照射により露光部に酸を生成させ、この酸を触媒とする反応によって、活性放射線の照射部と非照射部の現像液に対する溶解性を変化させパターンを基板上に形成させるパターン形成材料である。

【0003】上記化学増幅型ポジレジスト組成物は、アルカリ可溶性樹脂、放射線露光によって酸を発生する化合物(光酸発生剤)、及び酸分解性基を有するアルカリ可溶性樹脂に対する溶解阻止化合物から成る3成分系と、酸との反応により分解しアルカリ可溶となる基を有する樹脂と光酸発生剤からなる2成分系、更に酸との反応により分解しアルカリ可溶となる基を有する樹脂、酸分解性基を有する低分子溶解阻止化合物、及び光酸発生40剤から成るハイブリット系に大別できる。

【0004】特開平9-319092号公報において、 オキシ連結を導入したアセタール基を導入した樹脂が定 在波低減効果等に効果があるとして開示されている。

【0005】また、特開平10-221854号公報では、置換アセタール基のユニットを持つ樹脂が開示されている。

【0006】しかしながら、これらのアセタール基を有する樹脂では、電子線レジストとして用いた場合、電子線後方散乱の影響が強く現れ、得られるレジストパター 50

ンが逆テーパー形状のプロファイルとなった。更に電子 線照射装置の真空チャンバー中での引き置き時間による 線幅変動の改善も望まれていた。

2

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、電子線、X線、又はEUV (Extreme Ultraviolet)等の活性放射線による照射用のレジストとして、得られるパターンプロファイルの形状が優れ、更に照射装置の真空チャンバー中での引き置き時間による線幅変動も改善された化学増幅型ポジ型レジスト組成物を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者は、かかる現状に鑑み、鋭意検討した結果、特定の構造の酸分解性基を有する化合物を有するポジ型レジスト組成物を用いることで、上記目的が達成され、本発明を完成するに到った。

【0009】即ち、本発明に係るポジ型レジスト組成物は下記構成である。

(1) (a) 下記一般式(X) で示される基を含有する 構造単位を有し、酸の作用により分解してアルカリ現像 液に対する溶解性が増大する樹脂、及び(b) 活性放射 線の照射により酸を発生する化合物を含有することを特 徴とするポジ型電子線、X線又はEUV用レジスト組成 物。

[0010]

【化2】

【0011】式(X)中、R₁、R₂は、同一でも異なっていてもよく、水素原子、炭素数1~4のアルキル基を表し、Wは2価の有機基を表し、R₃は総炭素数11~20の置換基を有してもよいアルキル基、総炭素数1~30の置換基を有してもよいアリール基、総炭素数12~30の置換基を有してもよいアラルキル基を表す。

【0012】以下に、好ましい態様を記載する。

(2) (a) 下記一般式(I) 及び一般式(III) で示される構造単位を有する、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂、及び/又は、下記一般式(I)、一般式(II) 及び一般式(II I) で示される構造単位を有する、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂、及び(b) 活性放射線の照射により酸を発生する化合物を含有することを特徴とするポジ型電子線、X線又はEU V用レジスト組成物。

[0013]

【化3】

$$\begin{array}{c} R21 \\ -(CH_2-C) \\ \hline \\ (R23)_n \end{array}$$
(III)

【0014】式(I)~(III)中、R21は水素原子 又はメチル基を表し、R22は酸の作用により分解しな い基を表し、R23は水素原子、ハロゲン原子、アルキ ル基、アリール基、アルコキシ基、アシル基又はアシロ キシ基を表す。nは1~3の整数を表す。Wは上記一般 20 式(X)で示される基を表す。

【0015】(3) 上記一般式(X)において、 R_1 、 R_2 の少なくとも何れかが炭素数 $1 \sim 4$ の直鎖又は分岐のアルキル基であることを特徴とする上記(1)又は(2)に記載のポジ型電子線、X線又はEUV用レジスト組成物。

【0016】(4) 上記(b)活性放射線の照射により酸を発生する化合物が、活性放射線の照射により、スルホン酸を発生する下記一般式(A-1)、(A-2)、(A-3)、(A-4)、(A-5)、(A-6)及び(A-7)で表される化合物のうち少なくとも1種であることを特徴とする上記(1)~(3)のいずれかに記載のポジ型電子線、X線又はEUV用レジスト組成物。

[0017] [化4]

【0018】式(A-1)、(A-2)中、R₁~R 5は、同一でも異なっていてもよく、水素原子、アルキ ル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、ヒドロキシ 基、ハロゲン原子、又は-S-R₆基を示す。R₆はアル キル基、又はアリール基を示す。

【0019】X・は、(a)直鎖状、分岐状又は環状の 炭素数1~12個のアルキルスルホン酸のアニオンで、 その水素原子の一部又は全部をフッ素原子で置換されて いても良い、又は(b)分岐状又は環状の炭素数8個以 上のアルキル基及びアルコキシ基の群の中から選ばれる 基を少なくとも1個有するか、直鎖状、分岐状又は環状 の炭素数4~7個のアルキル基及びアルコキシ基の群の 中から選ばれる基を少なくとも2個有するか、直鎖状又 は分岐状の炭素数1~3個のアルキル基及びアルコキシ 基の群の中から選ばれる基を少なくとも3個有するか、 1~5個のハロゲン原子を有するか、若しくは直鎖状又 は分岐状の炭素数1~10のエステル基を有するベンゼ ンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸又はアントラセン スルホン酸のアニオン、を示す。

[0020]

【化5】

40

$$(R_7)_m$$
 $(R_9)_p$
 $(R_9)_p$
 $(R_9)_n$
 $(R_9)_q$
 $(R_{10})_q$

【0021】式 (A-3) 中、 $R_7 \sim R_{10}$ は、同一でも 異なっていてもよく、各々水素原子、アルキル基、シク ロアルキル基、アルコキシ基、ヒドロキシ基、又はハロ ゲン原子を示す。X・は、上記と同義である。m、n、 p及び q は、各々 $1\sim3$ の整数を示す。

20

5 .

[0022] 【化6】 $(R_{11})_{j}$ R_{11} $(R_{12})_{m}$ $(R_{12})_{m}$ (A-4)

【0023】式(A-4)中、R11~R13は、同一でも 異なっていてもよく、水素原子、アルキル基、シクロア ルキル基、アルコキシ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子 又は一S-R6基を示す。R6、X-は上記と同義であ る。1、m及びnは、同じでも異なってもよく、1~3 の整数を示す。1、m及びnが各々2又は3の場合、2 ~3個のR11~R13のうちの各々の2個が互いに結合し て、炭素環、複素環又は芳香環を含む5~8個の元素か ら成る環を形成してもよい。

[0024]

【化7】

$$(R_{14})_1$$
 $(R_{16})_n$
 $(R_{15})_m$
 $(A-5)$

【0025】式 (A-5) 中、R14~R16は、同一でも 異なっていてもよく、水素原子、アルキル基、シクロア ルキル基、アルコキシ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子 又は一S-R6基を示す。R6、X-は前記と同義であ る。1、m及びnは、同じでも異なってもよく、1~3 の整数を示す。1、m及びnが各々2又は3の場合、2 ~3個のR14~R16のうちの各々の2個が互いに結合し て、炭素環、複素環又は芳香環を含む5~8個の元素か ら成る環を形成してもよい。

[0026]

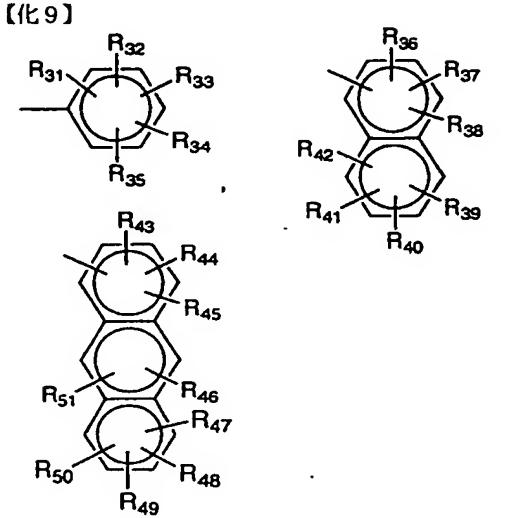
【化8】

【0027】式(A-6)中、Yは置換基を有していて so ポジ型電子線、X線又はEUV用レジスト組成物。

もよい直鎖、分岐、環状アルキル基、置換されていても よいアラルキル基、

6

[0028]



【0029】で表される基を示す(R31~R51は、同一 でも異なっていてもよく、水素原子、置換基を有してい てもよい直鎖、分岐、環状アルキル基、アルコキシ基、 アシル基、アシルアミノ基、スルホニルアミノ基、アリ ール基、アシロキシ基、アラルキル基もしくはアルコキ シカルボニル基、又はホルミル基、ニトロ基、塩素原 子、臭素原子、ヨウ素原子、水酸基、もしくはシアノ基 を示し、R31~R35、R36~R42及びR43~R51はそれ ぞれの群のうちの2つが結合して炭素原子及び/又はへ テロ原子からなる5~8員環を形成していもよい)。ま た、Yは別のイミドスルホネート化合物の残基と結合し ていてもよい。

【0030】Xは置換基を有していてもよい直鎖、分岐 アルキレン基、置換基を有していてもよくヘテロ原子を 含んでいてもよい単環又は多環環状アルキレン基、置換 されていてもよい直鎖、分岐アルケニレン基、置換され ていてもよくヘテロ原子を含んでいてもよい単環又は多 環環状アルケニレン基、置換されていてもよいアリーレ ン基、置換されていてもよいアラルキレン基を示す。ま た、Xは別のイミドスルホネート残基と結合していても 40 よい。

[0031]

 $A r_1 - S O_2 - S O_2 - A r_2$ (A-7)式(A-7)中、Ari、Arzは、同一でも異なってい てもよく、置換もしくは未置換のアリール基を示す。

【0032】(5) 上記(b)活性放射線の照射によ り酸を発生する化合物が、活性放射線の照射により、ス ルホン酸を発生する下記一般式(PAG3)及び(PA G 4) で表される化合物のうち少なくとも 1 種であるこ とを特徴とする上記(1)~(3)のいずれかに記載の 【0034】式中、Ar¹、Ar²は、各々独立に、置換 もしくは未置換のアリール基を示す。R²⁰³、R²⁰⁴、R ²⁰⁵ は、各々独立に、置換もしくは未置換のアルキル 基、アリール基を示す。

【0035】 Z^- は、少なくとも 1 つのフッ素原子を有するスルホン酸アニオンを示す。また R^{203} 、 R^{204} 、 R^{205} のうちの 2 つおよび A r^1 、A r^2 はそれぞれの単結合または置換基を介して結合してもよい。

【0036】(6) 更に、活性放射線の照射によりフッ素原子を含有しないスルホン酸を発生する化合物、及び、活性放射線の照射によりカルボン酸を発生する化合物の少なくともいずれかを含有することを特徴とする上記(5)に記載のポジ型電子線、X線又はEUV用レジ 20スト組成物。

- (7) 更に環状アミン化合物を含有することを特徴とする上記(1)~(6)のいずれかに記載のポジ型電子線、X線又はEUV用レジスト組成物。
- (8) 更にフッ素系界面活性剤又はシリコン系界面活 性剤又はその両方を含有することを特徴とする上記
- (1)~(7)のいずれかに記載のポジ型電子線、X線 又はEUV用レジスト組成物。
- (9) 酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する化合物をさらに含むことを特徴とす 30 る上記(1)~(8)のいずれかに記載のポジ型電子線、X線又はEUV用レジスト組成物。
- (10) 前記レジスト組成物中に含まれる酸の含有量が500ppm以下であることを特徴とする上記(1)~(9)のいずれかに記載のポジ型電子線、X線又はEUV用レジスト組成物。

[0037]

【発明の実施の形態】以下本発明を詳細に説明する。

(a) -1:上記一般式(X)で示される基を有する、 酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性 40 が増大する樹脂

一般式(X)におけるR₁、R₂のアルキル基としては、 メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル 基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、 t-ブチル基等の炭素数1~4個のアルキル基が挙げら れる。

【0038】Wにおける2価の有機基としては、好ましくは置換基を有していてもよい、直鎖、分岐あるいは環状のアルキレン基、アリーレン基、ヘテロアリーレン基、アラルキレン基並びに、-S-、-C(=0)-、

 $-N(R_4)$ -、-SO-、 $-SO_2-$ 、 $-CO_2-$ 、 $-N(R_4)$ SO_2- あるいはこれらの基を 2 つ以上組み合わせた 2 価の基を挙げることができる。ここで R_4 は水素原子又はアルキル基(アルキル基の具体例としては上記 R_1 と同様のものが挙げられる)を挙げることができる。

8

【0039】R3における総炭素数11~20の置換基を有してもよいアルキル基としては、総炭素数11~20の置換基を有してもよい鎖状アルキル基、総炭素数11~20の置換基を有してもよい環状アルキル基が挙げられる。

【0040】上記R3の炭素数11~20、好ましくは 炭素数11~18、の鎖状アルキル基としては、直鎖状 であっても分岐状であっても良く、例えばnーウンデシ ル基、iーウンデシル基、nードデシル基、iードデシ ル基、nートリデシル基、iートリデシル基、nーテト ラデシル基、iーテトラデシル基、nーペンタデシル 基、iーペンタデシル基、nーヘキサデシル基、iーへ キサデシル基、nーヘプタデシル基、iーへプタデシル 基、nーオクタデシル基、iーオクタデシル基、nーノ ナデシル基、iーノナデシル基等を挙げることができ る。

【0041】上記R3の炭素数11~20、好ましくは 炭素数11~18、の環状アルキル基としては、20ま での炭素数で環を形成する場合でも置換基を有した環状 アルキルでも良く、例えばシクロウンデシル基、シクロ ドデシル基、シクロトリデシル基、シクロトリデシル 基、シクロテトラデシル基、シクロペンタデシル基、シ クロヘキサデシル基、シクロヘプタデシル基、シクロオ **クタデシル基、シクロノナデシル基、4-シクロヘキシ** ルシクロヘキシル基、4-n-ヘキシルシクロヘキシル 基、ペンタニルシクロヘキシル基、ヘキシルオキシシク ロヘキシル基、ペンタニルオキシシクロヘキシル基等を 挙げることが出来る。ここに挙げた以外の置換環状アル キル基も上記範囲内であれば使用できることができる。 【0042】上記R3の炭素数11~30、好ましくは 炭素数11~25、のアリール基としては、4-シクロ ペンチルフェニル基、4-シクロヘキシルフェニル基、 4-シクロヘプテニルフェニル基、4-シクロオクタニ ルフェニル基、2-シクロペンチルフェニル基、2-シ クロヘキシルフェニル基、2-シクロヘプテニルフェニ ル基、2ーシクロオクタニルフェニル基、3ーシクロペ ンチルフェニル基、3ーシクロヘキシルフェニル基、3 ーシクロヘプテニルフェニル基、3ーシクロオクタニル フェニル基、4ーシクロペンチルオキシフェニル基、4 ーシクロヘキシルオキシフェニル基、4ーシクロヘプテ ニルオキシフェニル基、4ーシクロオクタニルオキシフ ェニル基、2ーシクロペンチルオキシフェニル基、2ー シクロヘキシルオキシフェニル基、2-シクロヘプテニ 50 ルオキシフェニル基、2ーシクロオクタニルオキシフェ

.

10

ニル基、3ーシクロペンチルオキシフェニル基、3ーシ クロヘキシルオキシフェニル基、3-シクロヘプテニル オキシフェニル基、3ーシクロオクタニルオキシフェニ ル基、4-n-ペンチルフェニル基、4-n-ヘキシル フェニル基、4-n-ヘプテニルフェニル基、4-n-オクタニルフェニル基、2-n-ペンチルフェニル基、 2-n-ヘキシルフェニル基、2-n-ヘプテニルフェ ニル基、2-n-オクタニルフェニル基、3-n-ペン チルフェニル基、3-n-ヘキシルフェニル基、3-n ーヘプテニルフェニル基、3-n-オクタニルフェニル 10 基、2,6-ジーイソプロピルフェニル基、2,3-ジ ーイソプロピルフェニル基、2.4-ジーイソプロピル フェニル基、3,4ージーイソプロピルフェニル基、 3, 6 - ジー t - プチルフェニル基、2, 3 - ジー t -ブチルフェニル基、2, 4-ジーtーブチルフェニル 基、3,4-ジーtープチルフェニル基、2,6-ジー nープチルフェニル基、2,3ージーnープチルフェニ ル基、2,4ージーnープチルフェニル基、3,4ージ -n-プチルフェニル基、2,6-ジーi-ブチルフェ ニル基、2, 3ージーiーブチルフェニル基、2, 4ー 20 ジーiープチルフェニル基、3,4ージーiープチルフ ェニル基、2,6-ジーt-アミルフェニル基、2,3 ージーtーアミルフェニル基、2,4-ジーt-アミル フェニル基、3, 4 - ジーt - アミルフェニル基、2, 6ージーiーアミルフェニル基、2,3ージーiーアミ ルフェニル基、2, 4 - ジーi-アミルフェニル基、 3, 4 ージー i ーアミルフェニル基、2, 6 ージーnー ペンチルフェニル基、2,3-ジーn-ペンチルフェニ ル基、2、4-ジーn-ペンチルフェニル基、3、4-ジーnーペンチルフェニル基、4ーアダマンチルフェニ 30 ル基、2-アダマンチルフェニル基、4-イソボロニル フェニル基、3ーイソボロニルフェニル基、2ーイソボ ロニルフェニル基、4ーシクロペンチルオキシフェニル 基、4ーシクロヘキシルオキシフェニル基、4ーシクロ ヘプテニルオキシフェニル基、4ーシクロオクタニルオ キシフェニル基、2ーシクロペンチルオキシフェニル 基、2ーシクロヘキシルオキシフェニル基、2-シクロ ヘプテニルオキシフェニル基、2-シクロオクタニルオ キシフェニル基、3ーシクロペンチルオキシフェニル 基、3ーシクロヘキシルオキシフェニル基、3ーシクロ 40 ヘプテニルオキシフェニル基、3-シクロオクタニルオ キシフェニル基、4-n-ペンチルオキシフェニル基、 4-n-ヘキシルオキシフェニル基、4-n-ヘプテニ ルオキシフェニル基、4-n-オクタニルオキシフェニ ル基、2-n-ペンチルオキシフェニル基、2-n-ヘ キシルオキシフェニル基、2-n-ヘプテニルオキシフ ェニル基、2-n-オクタニルオキシフェニル基、3n-ペンチルオキシフェニル基、3-n-ヘキシルオキ ジフェニル基、3-n-ヘプテニルオキシフェニル基、 3-n-オクタニルオキシフェニル基、2,6-ジーイ 50

ソプロピルオキシフェニル基、2,3ージーイソプロピ ルオキシフェニル基、2,4-ジーイソプロピルオキシ フェニル基、3, 4-ジーイソプロピルオキシフェニル 基、2,6-ジーt-ブチルオキシフェニル基、2,3 ージー t ープチルオキシフェニル基、2, 4 ージー t ー ブチルオキシフェニル基、3,4-ジーtーブチルオキ シフェニル基、2,6-ジーn-プチルオキシフェニル 基、2,3-ジーn-プチルオキシフェニル基、2,4 ージーnーブチルオキシフェニル基、3,4ージーnー ブチルオキシフェニル基、2,6-ジーi-ブチルオキ シフェニル基、2,3-ジー1-ブチルオキシフェニル 基、2,4-ジーiーブチルオキシフェニル基、3,4 ージー i ープチルオキシフェニル基、2, 6 ージー t ー アミルオキシフェニル基、2,3-ジーt-アミルオキ シフェニル基、2, 4-ジーt-アミルオキシフェニル 基、3,4-ジーt-アミルオキシフェニル基、2,6 ージー1ーアミルオキシフェニル基、2,3ージー1ー アミルオキシフェニル基、2, 4 ージー i ーアミルオキ シフェニル基、3, 4ージーiーアミルオキシフェニル 基、2,6-ジーn-ペンチルオキシフェニル基、2, 3 - ジーn - ペンチルオキシフェニル基、2, 4 - ジー nーペンチルオキシフェニル基、3,4ージーnーペン チルオキシフェニル基、4ーアダマンチルオキシフェニ ル基、3-アダマンチルオキシフェニル基、2-アダマ ンチルオキシフェニル基、4-イソボロニルオキシフェ ニル基、3ーイソボロニルオキシフェニル基、2ーイソ ボロニルオキシフェニル基、等が挙げられこれらは上記 範囲内であればさらに置換しても良く上記例以外の置換 基に限定しない。

【0043】R3の炭素数12~30、好ましくは炭素 数12~25、のアラルキル基としては、4-シクロペ ンチルフェニルエチル基、4-シクロヘキシルフェニル エチル基、4-シクロヘプテニルフェニルエチル基、4 ーシクロオクタニルフェニルエチル基、2-シクロペン チルフェニルエチル基、2-シクロヘキシルフェニルエ チル基、2ーシクロヘプテニルフェニルエチル基、2ー シクロオクタニルフェニルエチル基、3ーシクロペンチ ルフェニルエチル基、3-シクロヘキシルフェニルエチ ル基、3ーシクロヘプテニルフェニルエチル基、3ーシ クロオクタニルフェニルエチル基、4-シクロペンチル オキシフェニルエチル基、4-シクロヘキシルオキシフ ェニルエチル基、4ーシクロヘプテニルオキシフェニル エチル基、4ーシクロオクタニルオキシフェニルエチル 基、2ーシクロペンチルオキシフェニルエチル基、2ー シクロヘキシルオキシフェニルエチル基、2-シクロヘ プテニルオキシフェニルエチル基、2-シクロオクタニ ルオキシフェニルエチル基、3-シクロペンチルオキシ フェニルエチル基、3-シクロヘキシルオキシフェニル エチル基、3ーシクロヘプテニルオキシフェニルエチル 基、3-シクロオクタニルオキシフェニルエチル基、4

- n - ペンチルフェニルエチル基、4-n-ヘキシルフ ェニルエチル基、4-n-ヘプテニルフェニルエチル 基、4-n-オクタニルフェニルエチル基、2-n-ペ ンチルフェニルエチル基、2-n-ヘキシルフェニルエ チル基、2-n-ヘプテニルフェニルエチル基、2-n ーオクタニルフェニルエチル基、3-n-ペンチルフェ ニルエチル基、3-n-ヘキシルフェニルエチル基、3 - n - ヘプテニルフェニルエチル基、3-n-オクタニ ルフェニルエチル基、2,6-ジーイソプロピルフェニ ルエチル基、2、3ージーイソプロピルフェニルエチル 10 基、2,4-ジーイソプロピルフェニルエチル基、3, 4-ジーイソプロピルフェニルエチル基、2,6-ジー tープチルフェニルエチル基、2.3ージーtープチル フェニルエチル基、2, 4ージーtーブチルフェニルエ チル基、3, 4 ージー t ーブチルフェニルエチル基、 2, 6-ジーnープチルフェニルエチル基、2, 3-ジ ーnープチルフェニルエチル基、2,4ージーnープチ ルフェニルエチル基、3,4-ジーn-プチルフェニル エチル基、2, 6-ジーi-ブチルフェニルエチル基、 2, 3 ージー i ープチルフェニルエチル基、2, 4 ージ 20 ーiーブチルフェニルエチル基、3,4ージーiーブチ ルフェニルエチル基、2,6-ジーt-アミルフェニル エチル基、2, 3-ジーt-アミルフェニルエチル基、 2, 4 ージー t ーアミルフェニルエチル基、3, 4 ージ - t - アミルフェニルエチル基、2, 6 - ジーi - アミ ルフェニルエチル基、2,3-ジーi-アミルフェニル エチル基、2, 4ージーiーアミルフェニルエチル基、 3, 4 ージー i ーアミルフェニルエチル基、2, 6 ージ -n-ペンチルフェニルエチル基、2,3-ジ-n-ペ ンチルフェニルエチル基、2,4-ジーn-ペンチルフ 30 ェニルエチル基、3, 4-ジーn-ペンチルフェニルエ チル基、4ーアダマンチルフェニルエチル基、3ーアダ マンチルフェニルエチル基、2-アダマンチルフェニル エチル基、4ーイソポロニルフェニルエチル基、3ーイ ソボロニルフェニルエチル基、2-イソボロニルフェニ ルエチル基、4-シクロペンチルオキシフェニルエチル 基、4-シクロヘキシルオキシフェニルエチル基、4-シクロヘプテニルオキシフェニルエチル基、4-シクロ オクタニルオキシフェニルエチル基、2-シクロペンチ ルオキシフェニルエチル基、2-シクロヘキシルオキシ 40 フェニルエチル基、2-シクロヘプテニルオキシフェニ ルエチル基、2-シクロオクタニルオキシフェニルエチ ル基、3-シクロペンチルオキシフェニルエチル基、3 ーシクロヘキシルオキシフェニルエチル基、3ーシクロ ヘプテニルオキシフェニルエチル基、3-シクロオクタ ニルオキシフェニルエチル基、4-n-ペンチルオキシ フェニルエチル基、4-n-ヘキシルオキシフェニルエ チル基、4-n-ヘプテニルオキシフェニルエチル基、 4-n-オクタニルオキシフェニルエチル基、2-n-ペンチルオキシフェニルエチル基、2-n-ヘキシルオ 50

キシフェニルエチル基、2-n-ヘプテニルオキシフェ ニルエチル基、2-n-オクタニルオキシフェニルエチ ル基、3-n-ペンチルオキシフェニルエチル基、3nーへキシルオキシフェニルエチル基、3-n-ヘプテ ニルオキシフェニルエチル基、3-n-オクタニルオキ シフェニルエチル基、2,6-ジーイソプロピルオキシ フェニルエチル基、2,3ージーイソプロピルオキシフ ェニルエチル基、2,4-ジーイソプロピルオキシフェ ニルエチル基、3, 4ージーイソプロピルオキシフェニ ルエチル基、2,6-ジーt-ブチルオキシフェニルエ チル基、2, 3-ジーt-ブチルオキシフェニルエチル 基、2,4-ジーt-ブチルオキシフェニルエチル基、 3, 4-ジーtーブチルオキシフェニルエチル基、2, 6-ジーn-ブチルオキシフェニルエチル基、2.3-ジーnープチルオキシフェニルエチル基、2,4ージー nープチルオキシフェニルエチル基、3,4-ジーn-ブチルオキシフェニルエチル基、2,6-ジーiーブチ ルオキシフェニルエチル基、2,3-ジーi-ブチルオ キシフェニルエチル基、2, 4-ジーi-ブチルオキシ フェニルエチル基、3, 4 ージー i ープチルオキシフェ ニルエチル基、2, 6-ジーt-アミルオキシフェニル エチル基、2,3-ジーt-アミルオキシフェニルエチ ル基、2, 4-ジーt-アミルオキシフェニルエチル 基、3,4-ジーt-アミルオキシフェニルエチル基、 2, 6-ジー1-アミルオキシフェニルエチル基、2, 3 ージー i ーアミルオキシフェニルエチル基、2, 4 ー ジーiーアミルオキシフェニルエチル基、3,4ージー i ーアミルオキシフェニルエチル基、2,6 ージーnー ペンチルオキシフェニルエチル基、2,3-ジーn-ペ ンチルオキシフェニルエチル基、2,4-ジーnーペン チルオキシフェニルエチル基、3,4-ジーn-ペンチ ルオキシフェニルエチル基、4-アダマンチルオキシフ ェニルエチル基、3-アダマンチルオキシフェニルエチ ル基、2-アダマンチルオキシフェニルエチル基、4-イソボロニルオキシフェニルエチル基、3ーイソボロニ ルオキシフェニルエチル基、2-イソボロニルオキシフ ェニルエチル基、あるいは、上記アルキルがメチル基、 プロピル基、ブチル基などに置き換えたもの等が挙げら れる。

【0044】また、上記基の更なる置換基としては、水酸基、ハロゲン原子(フツ素、塩素、臭素、ヨウ素)、ニトロ基、シアノ基、上記のアルキル基、メトキシ基・エトキシ基・ヒドロキシエトキシ基・プロポキシ基・ヒドロキシプロポキシ基・nープトキシ基・イソブトキシ基・secープトキシ基・tープトキシ基等のアルコキシ基、メトキシカルボニル基・エトキシカルボニル基等のアルコキシカルボニル基、ベンジル基・フェネチル基・クミル基等のアラルキル基、アラルキルオキシ基、ホルミル基・アセチル基・ブチリル基・ベンゾイル基・シアナミル基・バレリル基等のアシル基、ブチリルオキシ

基等のアシロキシ基、上記のアルケニル基、ビニルオキシ基・プロペニルオキシ基・アリルオキシ基・ブテニルオキシ基等のアルケニルオキシ基、上記のアリール基、フエノキシ基等のアリールオキシ基、ベンゾイルオキシ基等のアリールオキシカルボニル基を挙げることができる。

【0045】R3の置換基としては、好ましくは炭素数 11~25のアリール基又は炭素数12~25のアラル キル基である。これらの置換基はさらに置換基を有して もよく、置換アリール基や置換アラルキル基の炭素数が この範囲内であればよい。

【0046】また、上記一般式(X)において、 R_1 、 R_2 の少なくとも何れかが炭素数 $2\sim 4$ の直鎖又は分岐のアルキル基であることが好ましい。

【0047】一般式(X)で示される基の具体例を以下に示すが、これらに限定されるものではない。

[0048]

【化11】

[0049]

【化12】

16

[0050]

【化13】

-o+o~

[0051]

【化14】

19
$$33$$

$$-0$$

$$H$$

$$35$$

$$-0$$

$$H$$

$$37$$

$$-0$$

$$H$$

$$39$$

$$-0$$

$$H$$

$$41$$

$$42$$

$$-0$$

$$H$$

$$43$$

$$44$$

$$43$$

【0052】本発明における一般式(X)で示される基を有し、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂(以下、一般式(X)で示され 30 る基を有する樹脂ともいう)は、モノマーを重合して得られる、分子量分布を有する化合物に、一般式(X)で示される酸分解性基を導入した構造を有し、酸の作用によりアルカリ可溶性となる化合物のことである。

【0053】一般式(X)で示される基を有する樹脂としては、樹脂の主鎖又は側鎖、あるいは、主鎖及び側鎖の両方に、一般式(X)で示される基を有する樹脂である。この内、一般式(X)で示される基を側鎖に有する樹脂がより好ましい。

【0054】次に、一般式(X)で示される基が側鎖と 40 して結合する場合の母体樹脂としては、側鎖に一〇Hもしくは一COOH、好ましくは一R⁰ーCOOHもしくは一ArーOH基を有するアルカリ可溶性樹脂である。例えば、後述する酸分解性基を含有していないアルカリ可溶性樹脂を挙げることができる。ここで、一R⁰ーは置換基を有してもよい2価以上の脂肪族もしくは芳香族炭化水素を表し、一Arーは単環もしくは多環の置換基を有してもよい2価以上の芳香族基を表す。

【0055】本発明において好ましい母体樹脂としては、フェノール性水酸基を有するアルカリ可溶性樹脂で 50

ある。

【0056】本発明に用いられるフェノール性水酸基を有するアルカリ可溶性樹脂は、oー、mー又はpーヒドロキシスチレン(これらを総称してヒドロキシスチレンと言う)、あるいはoー、mー又はpーヒドロキシーαーメチルスチレン(これらを総称してヒドロキシーαーメチルスチレンと言う)に相当する繰り返し単位を少なくとも30モル%、好ましくは50モル%以上含有する共重合体又はそのホモポリマー、あるいは該単位のベンゼン核が部分的に水素添加された樹脂であることが好ましく、pーヒドロキシスチレンホモポリマーがより好ましい。

【0057】上記共重合体を共重合により調製するためのヒドロキシスチレン及びヒドロキシーαーメチルスチレン以外のモノマーとしては、アクリル酸エステル類、メタクリルアミド類、メタクリルアミド類、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、無水マレイン酸、スチレン、αーメチルスチレン、アセトキシスチレン、アルコキシスチレン類が好ましく、スチレン、アセトキシスチレン、tープトキシスチレンがより好ましい。

【0058】本発明では、このような樹脂中における一般式(X)で示される基を有する繰り返し単位(構造単

位)の含有量としては、全繰り返し単位に対して3モル%~50モル%が好ましく、より好ましくは5モル%~30モル%である。

【0059】本発明において一般式(X)で示される基を有する樹脂中には、上記一般式(X)で示される基以外に、他の酸分解性基を含んでいてもよい。

【0060】上記一般式(X)で示される基を含有する 樹脂は、対応するビニルエーテルを合成し、テトラヒドロフラン等の適当な溶媒に溶解したフェノール性水酸基含有アルカリ可溶性樹脂と既知の方法により反応させる 10 ことで得ることができる。反応は、通常酸性の触媒、好ましくは、酸性イオン交換樹脂や、塩酸、pートルエンスルホン酸あるいは、ピリジニウムトシレートのような塩の存在下実施される。対応する上記ビニルエーテルは、クロロエチルビニルエーテルのような活性な原料から、求核置換反応等の方法により合成することができ、また水銀やパラジウム触媒を用いて合成することができる。

【0061】また、別の方法として、対応するアルコールとビニルエーテルを用いてアセタール交換する方法に 20 よっても合成することができる。この場合、導入したい置換基をアルコールに持たせ、ビニルエーテルは t ーブチルビニルエーテルのような比較的不安定なビニルエーテルを混在させ、pートルエンスルホン酸やピリジニウムトシレートのような酸存在下実施される。

【0062】上記一般式(X)で示される基を含有する 樹脂の重量平均分子量は2000~2000のが好ま しく、3000~10000がより好ましく、500 0~5000が更に好ましい。

【0063】分子量分布(Mw/Mn)の範囲は、1.01~4.0であり、好ましくは1.05~3.00である。

【0064】このような分子量分布のポリマーを得るにはアニオン重合、ラジカル重合等の手法を用いることが好ましい。

【0065】このような一般式(X)で示される基を含有する樹脂の具体的構造を以下に例示するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

[0066]

【化15】

22

【0067】 【化16】

20

A-7

OH A-8

OH OH

OH

A-10

[0068] [化17] OH A-12

O-O-O-C₅H₁1 OH
A-13

O-O-O-O OH
A-14

O_{C5}H₁₁ O_H

A-15

【0069】 【化18】

40

20

30

40

25

A-20

【0070】 【化19】 26

20

30

40

27

[0 0 7 2] [代2 1] (代2 1] (H2 1) (H2 1] (H2 1

[0073] [化22]

28 OC5H11 A-34 A-35 A-36 Ad:アダマンチル A-37 A-38 [0074] 【化23】 O-C₁₅H₃₁ A-39

【0075】本発明で用いる樹脂(一般式(X)で示される基を含有する樹脂、一般式(I)及び一般式(III)で示される構造単位を有する、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂、及び/又は、上記一般式(I)、一般式(II)及び一般式(III)で示される構造単位を有する、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂)は、アルカリ溶解速度調整及び耐熱姓向上のために

A-40

合成段階においてポリヒドロキシ化合物を添加して、ポ リマー主鎖を多官能アセタール基で連結する架橋部位を 導入してもよい。

【0076】ポリヒドロキシ化合物の添加量は樹脂の水 酸基の数に対して、0.01~10mo1%、好ましく はO. 05~8mol%、更に好ましくはO. 1~5m o 1%である。

【0077】ポリヒドロキシ化合物としては、フェノー

ル性水酸基あるいアルコール性水酸基を2~6個持つも のがあげられ、好ましくは水酸基の数が2~4個であ り、更に好ましくは水酸基の数が2又は3個である。以 下に具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるもの ではない。

[0078] 【化24】

$$HO-(CH_2)_n-OH$$
 $n=2 \sim 8$
 HO
 OH
 $N=1 \sim 5$
 $N=1 \sim 5$

【0079】(a)-2:上記一般式(I)及び一般式 (III)で示される構造単位を有する、酸の作用により 分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂 40 ボニルオキシ基、アルキルアミドメチルオキシ基、アル **(以下、(A)-1の樹脂ともいう)、及び/又は、上** 記一般式(I)、一般式(II)及び一般式(III)で示 される構造単位を有する、酸の作用により分解し、アル カリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂(以下、

(A)-2の樹脂ともいう) R21は、水素原子又はメ チル基を表す。

【0080】R22における酸の作用により分解しない 基(酸安定基ともいう)としては、水素原子、ハロゲン 原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、 アリール基、アルキルオキシ基(但し、一〇一第3級ア 50

ルキルは除く)、アシル基、シクロアルキルオキシ基、 アルケニルオキシ基、アリールオキシ基、アルキルカル キルアミド基、アリールアミドメチル基、アリールアミ ド基等が挙げられる。酸安定基としては、好ましくはア シル基、アルキルカルボニルオキシ基、アルキルオキシ 基、シクロアルキルオキシ基、アリールオキシ基、アル キルアミドオキシ基、アルキルアミド基であり、より好 ましくはアシル基、アルキルカルボニルオキシ基、アル キルオキシ基、シクロアルキルオキシ基、アリールオキ シ基である。

【0081】R22の酸安定基において、アルキル基と しては、メチル基、エチル基、プロピル基、nープチル 基、secーブチル基、tーブチル基の様な炭素数1~4個のものが好ましく、シクロアルキル基としてはシクロプロピル基、シクロブチル基、シクロヘキシル基、アダマンチル基の様な炭素数3~10個のものが好ましく、アルケニル基としてはビニル基、プロペニル基、アリル基、ブテニル基の様な炭素数2~4個のものが好ましく、アルケニル基としてはビニル基、プロペニル基、アリル基、ブテニル基の様な炭素数2~4個のものが好ましく、アリール基としてはフエニル基、キシリル基、トルイル基、クメニル基、ナフチル基、アントラセニル 10基の様な炭素数6~14個のものが好ましい。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、ヒドロキシエトキシ基、プロポキシ基、エトキシ基、ヒドロキシエトキシ基、プロポキシ基、ヒドロキシプロポキシ基、ローブトキシ基、イソブトキシ基、secーブトキシ基等の炭素数1~4個のアルコキシ基が好ましい。

【0082】上記R23におけるハロゲン原子として は、フッ素、塩素、臭素、沃素が好ましく、アルキル基 としては、メチル、エチル、プロピル、nーブチル、s e c ープチル、t ープチル、ヘキシル、オクチル等のよ うな炭素数1~8個のものが好ましく、アリール基とし 20 ては、フェニル、キシリル、トルイル、クメニル、ナフ チル、アントラセニル等のような炭素数6~14のもの が好ましい。アルコキシ基としては、メトキシ、エトキ シ、ヒドロキシエトキシ、プロポキシ、ヒドロキシプロ ポキシ、nープトキシ、イソプトキシ、secープトキ シ、 t ープトキシ等のような炭素数 1 ~ 4 個のものが好 ましく、アシル基としては、ホルミル、アセチル、プロ パノイル、ブタノイル、ベンゾイル等の炭素数1~7の ものが好ましく、アシロキシ基としては、アセトキシ、 プロプノイルオキシ、ブタノイルオキシ、ベンゾイルオ 30 キシ等の炭素数2~7個のものが好ましい。

【0083】一般式(I) における置換基Wは、前記一般式(X) のことであり、一般式(X) は前述の通りである。

【0084】このような一般式(I)で示される構造単位の具体的構造を以下に例示するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

[0085]

【化25】

[0086] 【化26】

20

33

【0087】 【化27】 34

30 【0088】

20

40

36

[0089] 【化29】

【0091】一般式(II)で表される構造単位を樹脂に 。 含有させることにより、該樹脂が酸の作用により分解

し、アルカリ現像液中での溶解度を制御することができ る。また、この構造単位を導入することによって矩形性 の優れたプロファイルを達成できる。さらには、一般式 (1) で表される構造単位の畳を調整するのに有効であ る。

【0092】このような一般式(II)で示される構造単 位の重合性モノマーの具体例としては、以下のものが挙 げられるが、これらに限定されるものではない。

[0093]

$$\{\{t:31\}\}$$

$$\{t:31\}$$

[0094]

【化32】

【0095】これら一般式(II)、又は一般式(III)で示される構造単位を含む樹脂は、フェノール樹脂あるいは、そのモノマーへ、塩基存在下で酸無水物と反応させることにより、あるいは塩基存在下対応するハライドと反応させることなどにより得ることができる。

【0096】本発明の(A) - 1の樹脂における一般式(I) 及び一般式(III)で示される繰り返し構造単位の比率は、モル比で(一般式(I)で示される構造単位/一般式(III)で示される構造単位) 5/95~50/50であり、好ましくは10/90~30/70である。

【0097】また、本発明の(A)-2の樹脂における一般式(I)、一般式(II)及び一般式(III)で示される構造単位の比率が、下記①~④の条件を満足することが好ましい。

①0. 10 < (1) / (1) + (11) + (111) < 0. 25

②0. 0.1 < (II) / (I) + (II) + (III) < 0.15 (1) > (11)

④0.5<(I)/(I)+(II)<0.85(式中、(I)、(II)、(III)は、各々、一般式(I)、一般式(II)及び一般式(III)で示される構造単位のモル分率を表す。)

本発明において、(A)-1の樹脂又は(A)-2の樹脂は、一般式(I)、一般式(II)又は一般式(III)で表される構造単位の他に共重合成分として他のモノマー単位を含んでいてもよい。

【0098】一般式(I)、一般式(II)又は一般式(III)で示される繰り返し構造単位、又は他の重合性モノマーからの繰り返し構造単位は、各々一種、又は二種以上を組み合わせて樹脂中に存在させてもよい。

【0099】また、本発明のポジ型レジスト組成物において、(A)-1の樹脂又は(A)-2の樹脂は同時に存在しても良く、更に他の樹脂を併用させても良い。

【0100】本発明において、(A)-1の樹脂と

(A) - 2の樹脂が同時に存在する場合、(A) - 1の 50 樹脂の含有量は、樹脂全体に対して、20~90重量% であり、好ましくは40~70重量%である。

【0 1 0 1】また、(A) - 2 の樹脂の含有量は、樹脂全体に対して、20~90重量%であり、好ましくは30~50重量%である。

【0102】また本発明のポジ型レジスト組成物に含有される樹脂は、アルカリ現像液に対する良好な現像性を維持するために、アルカリ可溶性基、例えばフェノール性水酸基、カルボキシル基が導入され得るように適切な他の重合性モノマーが共重合されていてもよい。

【0103】上記の方法によって合成される本発明の

(A) -1の樹脂又は(A) -2の樹脂の分子量は、重量平均(Mw:ポリスチレン標準)で2,000以上、好ましくは3,000~100,000であり、より好ましくは5,000~40,000である。

【0 1 0 4】また、分散度(Mw/Mn)は、好ましく

は1.0~4.0、より好ましくは1.0~3.5、特に好ましくは1.0~3.0であり、分散度が小さい程、耐熱性、画像形成性(パターンプロファイル、デフォーカスラチチュード等)が良好となる。

【0105】本発明の一般式(I)、一般式(II)及び一般式(III)で示される繰り返し構造単位を有する樹脂((A)-2の樹脂)の具体例を以下に示すが、本発明がこれらに限定されるものではない。

【0106】尚、一般式(I)及び一般式(III)で示される繰り返し構造単位を有する樹脂((A)-1の樹脂)の具体例としては、上述の具体例(A-1)~(A-28)が挙げられるが、本発明がこれらに限定されるものではない。

[0107]

[0108]

【化34】

[0109]

30 【化35】

46

[0110] [化36]

O-O-C₅H₁₁
O-C₅H₁₁
O-C₅H₁₁
O-C₅H₁₁
O-C₆H₁₁
O-C

【0112】上記一般式(X)で示される基を有する樹 40 脂((A)-1の樹脂又は(A)-2の樹脂も含む)のポジ型レジスト組成物中(塗布溶媒を除く)の含有量は、好ましくは50~99重量%、更に好ましくは70~97重量%である。

【0113】また、本発明においては、他の酸分解性基を有する樹脂を併用してもよい。本発明における化学増幅型レジストにおいて用いられる他の酸により分解し、アルカリ現像液中での溶解性を増大させる基を有する樹脂としては、樹脂の主鎖又は側鎖、あるいは、主鎖及び側鎖の両方に、酸で分解し得る基を有する樹脂である。

この内、酸で分解し得る基を側鎖に有する樹脂がより好ましい。

【0114】酸で分解し得る基として好ましい基は、 $-COOA^0$ 、 $-O-B^0$ 基であり、更にこれらを含む基としては、 $-R^0-COOA^0$ 、又は $-Ar-O-B^0$ で示される基が挙げられる。

【0115】ここで A^0 は、 $-C(R^{01})(R^{02})(R^{03})$ 、 $-Si(R^{01})(R^{02})(R^{03})$ 又は-C

(R⁰⁴) (R⁰⁵) −O−R⁰⁶ 基を示す。B⁰は、−A⁰又は−CO−O−A⁰基を示す(R⁰、R⁰¹ ~R⁰⁶、及びAr は後述のものと同義)。

【0116】酸分解性基としては好ましくは、シリルエーテル基、クミルエステル基、アセタール基、テトラヒドロピラニルエステル基、エノールエステル基、第3級のアルキルエーテル基、第3級のアルキルエステル基、第3級のアルキルカーボネート基等である。更に好ましくは、第3級アルキルエステル基、第3級アルキルカーボネート基、クミルエステル基、アセタール基、テトラヒドロピラニルエーテル基である。

【0117】次に、これら酸で分解し得る基が側鎖として結合する場合の母体樹脂としては、側鎖に一〇Hもしくは一COOHを含有する基、好ましくは一Rº-COOH基もしくは一Ar-OH基を有するアルカリ可溶性樹脂である。例えば、後述するアルカリ可溶性樹脂を挙げることができる。

【0118】これらアルカリ可溶性樹脂のアルカリ溶解速度は、0.261Nテトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド(TMAH)で測定(23℃)して170A/秒以上のものが好ましい。特に好ましくは330A/秒以上のものである(Aはオングストローム)。

【0119】また、矩形プロファイルを達成する点から 遠紫外光やエキシマレーザー光に対する透過率が高いア ルカリ可溶性樹脂が好ましい。好ましくは、1 μ m 膜厚 の248 n m での透過率が20~90%である。

【0120】このような観点から、特に好ましいアルカリ可溶性樹脂は、oー, mー, pーポリ(ヒドロキシスチレン)及びこれらの共重合体、水素化ポリ(ヒドロキシスチレン)、ハロゲンもしくはアルキル置換ポリ(ヒドロキシスチレン)、ポリ(ヒドロキシスチレン)の一部、Oーアルキル化もしくはOーアシル化物、スチレンーヒドロキシスチレン共重合体、αーメチルスチレンーヒドロキシスチレン共重合体及び水素化ノボラック樹脂である。

【0121】本発明に用いられる酸で分解し得る基を有する樹脂は、アルカリ可溶性樹脂に酸で分解し得る基の前駆体を反応させる、もしくは、酸で分解し得る基の結合したアルカリ可溶性樹脂モノマーを種々のモノマーと共重合して得ることができる。

【0122】上記酸発生剤、酸で分解し得る基を有する

樹脂とともに、後記する酸分解性低分子溶解阻止化合物 を混合してもよい。

【0123】本発明に用いられる酸分解性溶解阻止化合 物としては、その構造中に酸で分解し得る基を少なくと も2個有し、該酸分解性基間の距離が最も離れた位置に おいて、酸分解性基を除く結合原子を少なくとも8個経 由する化合物である。

【0124】また、本発明に使用される酸分解性低分子 溶解阻止化合物は、一般式(X)で示される酸分解基を 少なくとも1種含有してもよい。

【0125】本発明において、好ましくは酸分解性溶解 阻止化合物は、その構造中に酸で分解し得る基を少なく とも2個有し、該酸分解性基間の距離が最も離れた位置 において、酸分解性基を除く結合原子を少なくとも10 個、好ましくは少なくとも11個、更に好ましくは少な くとも12個経由する化合物、又は酸分解性基を少なく とも3個有し、該酸分解性基間の距離が最も離れた位置 において、酸分解性基を除く結合原子を少なくとも9

$$B^0-O - \frac{1}{2} O-B^0$$

個、好ましくは少なくとも10個、更に好ましくは少な くとも11個経由する化合物である。又、上記結合原子 の好ましい上限は50個、更に好ましくは30個であ る。

【0126】本発明において、酸分解性溶解阻止化合物 が、酸分解性基を3個以上、好ましくは4個以上有する 場合、又酸分解性基を2個有するものにおいても、該酸 分解性基が互いにある一定の距離以上離れている場合、 アルカリ可溶性樹脂に対する溶解阻止性が著しく向上す る。

【0127】なお、本発明における酸分解性基間の距離 は、酸分解性基を除く、経由結合原子数で示される。例 えば、以下の化合物(1), (2)の場合、酸分解性基 間の距離は、各々結合原子4個であり、化合物(3)で は結合原子12個である。

[0128]【化38】

(1)

$$A^{0} - OOC - {}^{1}CH_{2} - {}^{2}CH_{2} - {}^{3}CH_{2} - {}^{4}CH_{2} - COO - A^{0}$$
 (2)

$$B^{0}-O$$

$$CH_{3}$$

$$B^{0}-O$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{4}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{4}$$

$$CH_{5}$$

$$CH_{5}$$

$$CH_{5}$$

$$CH_{5}$$

酸分解性基:—COO —A⁰、—O—B⁰

30

【0129】また、本発明の酸分解性溶解阻止化合物 は、1つのベンゼン環上に複数個の酸分解性基を有して いてもよいが、好ましくは、1つのベンゼン環上に1個 の酸分解性基を有する骨格から構成される化合物であ る。更に、本発明の酸分解性溶解阻止化合物の分子量は 3,000以下であり、好ましくは500~3,00 0、更に好ましくは1,000~2,500である。

【0130】本発明の好ましい実施態様においては、酸 により分解し得る基、即ち一COO一Aº、一〇一Bº基 を含む基としては、一尺0-COO-A0、又は-Ar-40 ロブチル基、シクロヘキシル基、アダマンチル基の様な O-B⁰で示される基が挙げられる。

【0131】 ここで A^0 は、 $-C(R^{01})(R^{02})$ (R 03), -Si (R^{01}) (R^{02}) (R^{03}) &U < U - C(R⁰⁴)(R⁰⁵)−O−R⁰⁶ 基を示す。B⁰は、A⁰又は -CO-O-A⁰基を示す。

【O 1 3 2】R⁰¹、R⁰²、R⁰³、R⁰⁴及びR⁰⁵は、それ ぞれ同一でも相異していてもよく、水素原子、アルキル 基、シクロアルキル基、アルケニル基もしくはアリール 基を示し、R[®] はアルキル基もしくはアリール基を示 す。但し、R⁰¹ ~R⁰³ の内少なくとも 2 つは水素原子以 50 ロキシエトキシ基、プロポキシ基、ヒドロキシプロポキ

外の基であり、又、R⁰¹~R⁰³、及びR⁰⁴~R⁰⁶の内の 2つの基が結合して環を形成してもよい。R^oは置換基 を有していてもよい2価以上の脂肪族もしくは芳香族炭 化水素基を示し、-Ar-は単環もしくは多環の置換基 を有していてもよい2価以上の芳香族基を示す。

【0133】ここで、アルキル基としてはメチル基、エ チル基、プロピル基、nーブチル基、secーブチル 基、 t ープチル基の様な炭素数 1 ~ 4 個のものが好まし く、シクロアルキル基としてはシクロプロピル基、シク **炭素数3~10個のものが好ましく、アルケニル基とし** てはビニル基、プロペニル基、アリル基、プテニル基の 様な炭素数2~4個のものが好ましく、アリール基とし てはフエニル基、キシリル基、トルイル基、クメニル 基、ナフチル基、アントラセニル基の様な炭素数6~1 4個のものが好ましい。

【0134】また、置換基としては水酸基、ハロゲン原 子(フツ素、塩素、臭素、ヨウ素)、ニトロ基、シアノ 基、上記のアルキル基、メトキシ基、エトキシ基、ヒド

シ基、nーブトキシ基、イソブトキシ基、secーブトキシ基、tーブトキシ基等のアルコキシ基、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基等のアルコキシカルボニル基、ベンジル基、フエネチル基、クミル基等のアラルキル基、アラルキルオキシ基、ホルミル基、アセチル基、ブチリル基、ベンゾイル基、シアナミル基、バレリル基等のアシル基、ブチリルオキシ基等のアシロキシ基、上記のアルケニル基、ビニルオキシ基、プロペニルオキシ基、アリルオキシ基、ブテニルオキシ基等のアルケニルオキシ基、上記のアリール基、フエノキシ基等のアリールオキシ基、ベンゾイルオキシ基等のアリールオキシルボニル基を挙げることができる。

【0135】酸により分解しうる基として、好ましく は、シリルエーテル基、クミルエステル基、アセタール 基、テトラヒドロピラニルエーテル基、エノールエーテ ル基、エノールエステル基、第3級のアルキルエーテル 基、第3級のアルキルエステル基、第3級のアルキルカ ーボネート基等である。更に好ましくは、第3級アルキ ルエステル基、第3級アルキルカーボネート基、クミル エステル基、テトラヒドロピラニルエーテル基である。 【0136】酸分解性溶解阻止化合物としては、好まし くは、特開平1-289946号、特開平1-2899 47号、特開平2-2560号、特開平3-12895 9号、特開平3-158855号、特開平3-1793 53号、特開平3-191351号、特開平3-200 251号、特開平3-200252号、特開平3-20 0253号、特開平3-200254号、特開平3-2 00255号、特開平3-259149号、特開平3-279958号、特開平3-279959号、特開平4 -1650号、特開平4-1651号、特開平4-11 260号、特開平4-12356号、特開平4-123 57号、特願平3-33229号、特願平3-2307 90号、特願平3-320438号、特願平4-251 57号、特願平4-52732号、特願平4-1032 15号、特願平4-104542号、特願平4-107 885号、特願平4-107889号、同4-1521 95号等の明細書に記載されたポリヒドロキシ化合物の フエノール性OH基の一部もしくは全部を上に示した 基、-R⁰-COO-A⁰もしくはB⁰基で結合し、保護

した化合物が含まれる。

【0137】更に好ましくは、特開平1-289946号、特開平3-128959号、特開平3-158855号、特開平3-179353号、特開平3-200251号、特開平3-200255号、特開平3-259149号、特開平3-279958号、特開平4-1650号、特開平4-11260号、特開平4-12357号、特願平4-12357号、特願平4-104542号、特願平4-107885号、特願平4-1078889号、同4-152195号の明細書に記載されたポリヒドロキシ化合物を用いたものが挙げられる。

【0138】より具体的には、一般式 [I] ~ [X V I] で表される化合物が挙げられる。

[0139]

$$(R^{102}O)_{i}$$
 $(R^{106})_{i}$
 $(R^{107})_{j}$
 $(OR^{101})_{e}$
 $(R^{105})_{h}$

$$(R^{114})_0$$
 $(OR^{102})_1$ $(R^{113})_n$ $(OR^{101})_k$ $(R^{109})_0$ $(OR^{108})_m$ $(OR^{108})_m$

[0140] [化40]

$$(R^{108})_{s}$$
 $(R^{102}O)_{r}$
 $(R^{119})_{u}$
 $(R^{118})_{t}$
 $(R^{118})_{t}$

$$(R^{101}O)_{g1}$$
 $(R^{131})_{k1}$
 $(R^{108}O)_{i1}$
 $(R^{134})_{m1}$
 $(R^{134})_{m1}$
 $(R^{134})_{m1}$
 $(R^{134})_{m1}$
 $(R^{134})_{m1}$
 $(R^{134})_{m1}$

【O 1 4 1】 R¹⁰¹ 、 R¹⁰² 、 R¹⁰⁸ 、 R¹³⁰ :同一でも異 なっていてもよく、水素原子、一R0一COO一C(R (R^{02}) (R^{03}) 又は-CO-O-C (R^{01}) (R⁰²) (R⁰³)、但し、R⁰、R⁰¹、R⁰²及びR⁰³の定義 は前記と同じである。

[0142] R^{100} :-CO-, -COO-, -NHC ONH-, -NHCOO-, -O-, -S-, -SO 一、一SO2一、一SO3一、もしくは

[0143]

【化41】

$$\left(\begin{array}{c}
R^{150} \\
C \\
R^{151}
\end{array}\right)_{G}$$

【0144】ここで、G=2~6 但し、G=2の時は R 150 、 R 151 のうち少なくとも一方はアルキル基、 R 150 、 R 151 : 同一でも異なっていてもよく、水素原 子、アルキル基、アルコキシ基、一〇H、一〇〇〇H、 ーCN、ハロゲン原子、一R¹⁵² ーCOOR¹⁵³ もしくは $-R^{154}-OH$

R¹⁵²、R¹⁵⁴:アルキレン基、

R¹⁵³:水素原子、アルキル基、アリール基、もしくは アラルキル基、

R⁹⁹、R¹⁰³~R¹⁰⁷、R¹⁰⁹、R¹¹¹~R¹¹⁸、R¹³¹~R 40 r,u: Oもしくは1~4の整数、 134 :同一でも異なっても良く、水素原子、水酸基、ア ルキル基、アルコキシ基、アシル基、アシロキシ基、ア リール基、アリールオキシ基、アラルキル基、アラルキ ルオキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、カルボキシル 基、シアノ基、もしくは-N(R¹⁵⁵)(R¹⁵⁶)(R ¹⁵⁵ 、R¹⁵⁶ : H、アルキル基、もし くはアリール 基)

R110 :単結合、アルキレン基、もしくは

[0145]

【化42】

$$-R^{157}$$
 R^{159} R^{159}

54

【O 1 4 6】 R¹⁵⁷ 、 R¹⁵⁹ :同一でも異なってもよく、 単結合、アルキレン基、一〇一、一S一、一C〇一、も しくはカルボキシル基、

R 158 : 水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アシル 基、アシロキシ基、アリール基、ニトロ基、水酸基、シ アノ基、もしくはカルボキシル基、但し、水酸基が酸分 解性基(例えば、 t ープトキシカルボニルメチル基、テ トラヒドロピラニル基、1-エトキシー1-エチル基、 1-t-ブトキシー1-エチル基) で置き換ってもよ い。

【0147】R¹¹⁹、R¹²⁰:同一でも異なってもよく、 メチレン基、低級アルキル置換メチレン基、ハロメチレ ン基、もしくはハロアルキレン基、但し本発明において 低級アルキル基とは炭素数1~4のアルキル基を指す、 A:メチレン基、低級アルキル置換メチレン基、ハロメ チレン基、もしくはハロアルキレン基、

a~v、gl~n1:複数の時、括弧内の基は同一又は異なっ ていてもよい、

a~q、s,t,v,gl~i1,kl~ml:0もしくは1~5の整 数、

jl _nl : 0 もしくは 1 ~ 3 の整数、

 $(a+b), (e+f+g), (k+l+m), (q+r+s), (gl+hl+il+jl) \ge 2$ $(j1+n1) \leq 3$

 $(r+u) \leq 4$

(a+c), (b+d), (e+h), (f+i), (g+j), (k+n), (l+o), (m+p), (q+i)+t), (s+v), (g1+k1), (h1+l1), $(i1+m1) \le 5$, を表す。

[0148]

【化43】

R164 R¹⁶² R¹⁶⁴ R¹⁶⁵ R¹⁶⁵ **R**166 Ř¹⁶⁶ (VI) R¹⁶² R^{162} R¹⁶³ R¹⁶³ R¹⁶⁶ R¹⁶⁴ R¹⁶⁴ ¹R¹⁶⁵ R¹⁶⁶

ここで、 R¹⁶⁰: 有機基、単結合、一S一、一SO一、もしくは

R¹⁶²~R¹⁶⁶: 同一でも異なっていても良く、水素原子、水酸基、 ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルケ ニル基、-O-R⁰-COO-C(R⁰¹)(R⁰²)(R⁰³)もしくは -O-CO-O-C (R⁰¹) (R⁰²) (R⁰³) 、但し、少なくとも 2つは-0-R⁰-COO-C(R⁰¹)(R⁰²)(R⁰³) もしくは -O-CO-O-C(R⁰¹) (R⁰²) (R⁰³) である、又、各4もし くは6個の同一記号の置換基は同一の基でなくて も良い、

X:2価の有機基、 e2:0もしくは1、を表わす。

[0149]

【化44】

ここで、

R¹⁶⁷~R¹⁷⁰: 同一でも異なっても良く、水素原子、水酸基、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、もしくはアルケニル基、但し、各4~6個の同一記号の置換基は同一の基ではなくても良い、

 R^{173} : 少なくとも 2 つは $-O-R^0-COO-C(R^{01})(R^{02})(R^{03})$ 基もしくは $-O-CO-O-C(R^{01})(R^{02})(R^{03})$ 基であり、その他は水酸基である、

 $f_2, h_2: 0$ もしくは1、 $g_2: 0$ もしくは $1\sim 4$ の整数、を表す。

[0150]

【化45】

40

ここで、

R¹⁷⁴~R¹⁸⁰: 同一でも異なっても良く、水素原子、水酸基、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、ニトロ基、アルカール基、アリール基、アラルキル基、アルコキシカルボニル基、アリールカルボニル基、アシロキシ基、アシル基、アラルキルオキシ基、もしくはアリールオキシ基、但し、各6個の同一配号の置換基は同一の基ではなくても良い、

 R^{181} :少なくとも 2 つは $-O-R^0-COO-C(R^{01})$ (R^{02}) (R^{03}) 基もしくは $-O-CO-O-C(R^{01})$ (R^{02}) (R^{03}) 基であり、その他は、水酸基である、

を表す。

【0151】この場合、該溶解阻止化合物の含量は、レジスト組成物の全重量(溶媒を除く)を基準として3~45重量%、好ましくは5~30重量%、より好ましくは10~20重量%である。

【0152】更に、アルカリ溶解性を調節するために、 酸で分解し得る基を有さないアルカリ可溶性樹脂を混合 してもよい。

【0153】そのようなアルカリ可溶性樹脂としては、 例えばノボラック樹脂、水素化ノボラツク樹脂、アセト ンーピロガロール樹脂、oーポリヒドロキシスチレン、 mーポリヒドロキシスチレン、pーポリヒドロキシスチ レン、水素化ポリヒドロキシスチレン、ハロゲンもしく はアルキル置換ポリヒドロキシスチレン、ヒドロキシス 40 チレンーNー置換マレイミド共重合体、o/pー及びm /pーヒドロキシスチレン共重合体、ポリヒドロキシス チレンの水酸基に対する一部〇一アルキル化物(例え ば、5~30モル%の0ーメチル化物等)もしくは0-アシル化物(例えば、5~30モル%の0ーアセチル化 物等)、スチレン一無水マレイン酸共重合体、スチレン ーヒドロキシスチレン共重合体、αーメチルスチレンー ヒドロキシスチレン共重合体、カルボキシル基含有メタ クリル系樹脂及びその誘導体を挙げることができるが、 これらに限定されるものではない。

【0154】特に好ましいアルカリ可溶性樹脂はノボラック樹脂及びoーポリヒドロキシスチレン、mーポリヒドロキシスチレン及びこれらの共重合体、アルキル置換ポリヒドロキシスチレン、ポリヒドロキシスチレンの一部Oーアルキル化、もしくはOーアシル化物、スチレンーヒドロキシスチレン共重合体、αーメチルスチレンーヒドロキシスチレン共重合体である。該ノボラック樹脂は所定のモノマーを主成分として、酸性触媒の存在下、アルデヒド類と付加縮合させることにより得られる。

【0155】所定のモノマーとしては、フェノール、mークレゾール、pークレゾール、oークレゾール等のクレゾール類、2.5ーキシレノール、3.5ーキシレノール、3.4ーキシレノール、2.3ーキシレノール等のキシレノール類、mーエチルフェノール、pーエチルフェノール、pーオクチルフェノール、pーオクチルフェノール、2.3.5ートリメチルフェノール等のアルキルフェノール類、pーメトキシフェノール、mーメトキシフェノール、mーエトキシフェノール、pープロポキシフェノール、mープトキシフェノール、pープトキシフェノール、mープトキシフェノール、pープトキシフェノール等の

アルコキシフェノール類、2ーメチルー4ーイソプロピルフェノール等のビスアルキルフェノール類、mークロロフェノール、pークロロフェノール、cークロロフェノール、ジヒドロキシビフェニル、ビスフェノールA、フェニルフェノール、レゾルシノール、ナフトール等のヒドロキシ芳香化合物を単独もしくは2種類以上混合して使用することができるが、これらに限定されるものではない。

【0156】アルデヒド類としては、例えばホルムアル デヒド、パラホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、プ 10 ロピオンアルデヒド、ベンズアルデヒド、フェニルアセ トアルデヒド、αーフェニルプロピルアルデヒド、βー フェニルプロピルアルデヒド、oーヒドロキシベンズア ルデヒド、mーヒドロキシベンズアルデヒド、pーヒド ロキシベンズアルデヒド、oークロロベンズアルデヒ ド、mークロロベンズアルデヒド、pークロロベンズア ルデヒド、oーニトロベンズアルデヒド、mーニトロベ ンズアルデヒド、pーニトロベンズアルデヒド、oーメ チルベンズアルデヒド、mーメチルベンズアルデヒド、 pーメチルベンズアルデヒド、pーエチルベンズアルデ 20 ヒド、p-n-ブチルベンズアルデヒド、フルフラー ル、クロロアセトアルデヒド及びこれらのアセタール 体、例えばクロロアセトアルデヒドジエチルアセタール 等を使用することができるが、これらの中で、ホルムア ルデヒドを使用するのが好ましい。

【0157】これらのアルデヒド類は、単独でもしくは 2種類以上組み合わせて用いられる。酸性触媒としては 塩酸、硫酸、ギ酸、酢酸、シュウ酸等を使用することが できる。

【0158】こうして得られたノボラック樹脂の重量平 30 均分子量は、1000~3000の範囲であることが好ましい。1000未満では未露光部の現像後の膜減りが大きく30000を越えると現像速度が小さくなってしまう。特に好適なのは2000~2000の範囲である。

【0159】また、ノボラック樹脂以外の前記ポリヒドロキシスチレン、及びその誘導体、共重合体の重量平均分子量は、2000以上、好ましくは5000~2000、より好ましくは1000~10000である。また、レジスト膜の耐熱性を向上させるという観点40からは、25000以上が好ましい。

【0160】ここで、重量平均分子量はゲルパーミエーションクロマトグラフィーのポリスチレン換算値をもって定義される。

【0161】本発明におけるこれらのアルカリ可溶性樹脂は2種類以上混合して使用してもよい。

【0162】本発明におけるこれらのアルカリ可溶性樹脂の組成物中の添加量としては、好ましくは5~30重量%である。

【0163】本発明で用いられる酸発生剤(b)は、活 50

性放射線の照射により酸を発生する化合物である。

【O164】本発明で用いられる酸発生剤(b)として の活性放射線(電子線、X線又はEUV)の照射により 酸を発生する化合物とは、酸発生剤(b)を含有するレ ジスト膜が、活性放射線の照射を受けることにより、酸 を発生する化合物でさえあればよい。即ち、酸発生剤が 直接、照射を受け酸を発生する化合物であっても、照射 により樹脂などの構成成分から2次電子が放出され、そ れにより酸を発生する化合物であってもよい。本発明で 使用されるこのような化合物としては、光カチオン重合 の光開始剤、光ラジカル重合の光開始剤、色素類の光消 色剤、光変色剤、あるいはマイクロレジスト等に使用さ れている公知の光(400~200 nmの紫外線、遠紫 外線、特に好ましくは、g線、h線、i線、KrFエキ シマレーザー光)、ArFエキシマレーザー光、X線、 分子線又はイオンビームにより酸を発生する化合物及び それらの混合物の中から、適宜に選択して使用すること ができる。

【0165】たとえばジアゾニウム塩、アンモニウム塩、ホスホニウム塩、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、セレノニウム塩、アルソニウム塩等のオニウム塩、有機ハロゲン化合物、有機金属/有機ハロゲン化物、 oーニトロベンジル型保護基を有する酸発生剤、イミノスルフォネート等に代表される光分解してスルホン酸を発生する化合物、ジスルホン化合物を挙げることができる。

【0166】また、これらの酸を発生する基、あるいは 化合物をポリマーの主鎖又は側鎖に導入した化合物を用 いることができる。

【0 1 6 7】さらにV.N.R.Pillai,Synthesis,(1),1(198 0)、A.Abad etal,Tetrahedron Lett.(47)4555(1971)、D.H.R.Barton etal,J.Chem.Soc.(C),329(1970)、米国特許第3,779,778号、欧州特許第126,712号等に記載の光により酸を発生する化合物も使用することができる。

【0168】本発明においては、酸発生剤(b)として、上記一般式(A-1)~(A-7)で示される、活性放射線の照射により、スルホン酸を発生する化合物が好ましく使用される。以下、一般式(A-1)~(A-7)で示される化合物について詳細に説明する。

【0169】一般式 (A-1)~ (A-3)で示される 酸発生剤

前記一般式 (A-1) ~ (A-3) における、R1~R6 及びR7~R10 のアルキル基としては、置換基を有してもよい、メチル基、エチル基、プロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基のような炭素数1~4個のものが挙げられる。シクロアルキル基としては、置換基を有してもよい、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基のような炭素数3~8個のものが挙げられる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、ヒドロキシエトキシ基、プロポキシ

基、n-ブトキシ基、イソブトキシ基、sec-ブトキシ基、t-ブトキシ基のような炭素数1~4個のものが挙げられる。ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、沃素原子を挙げることができる。アリール基としては、フェニル基、トリル基、メトキシフェニル基、ナフチル基のような置換基を有してもよい炭素数6~14個のものが挙げられる。

【0170】 置換基として好ましくは、炭素数1~4個のアルコキシ基、ハロゲン原子(フッ素原子、塩素原子、沃素原子)、炭素数6~10個のアリール基、炭素 10数2~6個のアルケニル基、シアノ基、ヒドロキシ基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、ニトロ基等が挙げられる。

【OI71】本発明で使用される一般式(A-1)~ (A-3)で表わされるスルホニウム、ヨードニウム化 合物は、その対アニオン、X・として、(a)直鎖状、 分岐状又は環状の炭素数 1~12個のアルキルスルホン 酸のアニオンで、その水素原子の一部又は全部をフッ素 原子で置換されていても良い、又は(b)分岐状又は環 状の炭素数8個以上のアルキル基及びアルコキシ基の群 の中から選ばれる基を少なくとも 1 個有するか、直鎖 状、分岐状又は環状の炭素数4~7個のアルキル基及び アルコキシ基の群の中から選ばれる基を少なくとも2個 有するか、直鎖状又は分岐状の炭素数1~3個のアルキ ル基及びアルコキシ基の群の中から選ばれる基を少なく とも3個有するか、1~5個のハロゲン原子を有する か、若しくは直鎖状又は分岐状の炭素数1~10のエス テル基を有するベンゼンスルホン酸、ナフタレンスルホ ン酸又はアントラセンスルホン酸のアニオン、を有す る。

【0172】これにより露光後発生する酸(上記基を有するベンゼンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸、又はアントラセンスルホン酸)の拡散性が小さくなり、且つ該スルホニウム、ヨードニウム化合物の溶剤溶解性が向上する。

【0173】特に、拡散性を低減させるという観点からは上記基として直鎖状のアルキル基又はアルコキシ基より、分岐状又は環状のアルキル基又はアルコキシ基の方が好ましい。上記基が1個の場合は、直鎖状と分岐状又は環状との拡散性の差異はより顕著になる。

【0174】炭素数8個以上、好ましくは炭素数8~20個のアルキル基としては、分岐状又は環状のオクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、オクタデシル基等が挙げられる。

【0175】炭素数8個以上、好ましくは炭素数8~2 0個のアルコキシ基としては、分岐状又は環状のオクチルオキシ基、ノニルオキシ基、デシルオキシ基、ウンデシルオキシ基、ドデシルオキシ基、トリデシルオキシ 基、テトラデシルオキシ基、オクタデシルオキシ基等が 50

挙げられる。

【0176】炭素数4~7個のアルキル基としては、直鎖状、分岐状又は環状のブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基等が挙げられる。

【0177】炭素数4~7個のアルコキシ基としては、 直鎖状、分岐状又は環状のプトキシ基、ペンチルオキシ 基、ヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基等が挙げられ る。

【0178】炭素数1~3個のアルキル基としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基が挙げられる。

【0179】炭素数1~3個のアルコキシ基としては、 メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、イソプロ ポキシ基が挙げられる。

【0180】ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、沃素原子を挙げることができ、好ましくはフッ素原子である。

【0181】直鎖状、分岐状又は環状の炭素数1~10 個のエステルとしては、メチルエステル基、エチルエス テル基、nープロピルエステル基、iープロピルエステ ル基、nープチルエステル基、iープチルエステル基、 tーブチルエステル基、nーヘキシルエステル基、iー ヘキシルエステル基、tーヘキシルエステル基、nーヘ プチルエステル基、i-ヘプチルエステル基、t-ヘプ チルエステル基、ローオクチルエステル基、エーオクチ ルエステル基、tーオクチルエステル、nーノニルエス テル基、iーノニルエステル基、t-ノニルエステル 基、nーデカニルエステル基、iーデカニルエステル 基、t-デカニルエステル、シクロプロピルエステル 30 基、シクロプチルエステル基、シクロペンチルエステル 基、シクロヘキシルエステル基、シクロヘプチルエステ ル基、シクロオクチルエステル基、シクロノニルエステ ル基、シクロデカニルエステル基等が挙げられる。

【0182】直鎖状、分岐状又は環状の炭素数1~12個のアルキルスルホン酸のアニオンにおけるアルキル基としては、好ましくは炭素数1~12個のアルキル基、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nープチル基、イソプチル基、secープチル基、ペンチル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基等を挙げることができる。

【0183】また、X・で表されるアルキルスルホン酸、芳香族スルホン酸には、上記特定の置換基以外に、ハロゲン原子(フッ素原子、塩素原子、臭素原子、沃素原子)、炭素数6~10個のアリール基、シアノ基、スルフィド基、ヒドロキシ基、カルボキシ基、ニトロ基等を置換基として含有してもよい。

【0184】以下に、これらの化合物の具体例(A-1-1)~(A-1-66)、(A-2-1)~(A-2-1)~(A-3-35)を示す

66

が、これに限定されるものではない。 【0185】 【化46】

ÒН

1+ 1H₂₅C₁₂

$$(A-1-5)$$
 $(A-1-6)$
 $C_4H_9^t$
 $H_{21}C_{10}$
 $S^{-1}H_{25}C_{12}$
 $(A-1-7)$
 $(A-1-8)$

【0186】 【化47】

68

$${}^{0}-C_{4}H_{9}^{t}$$

$${}^{1}H_{25}C_{12}$$

$${}^{0}-C_{4}H_{9}^{t}$$

$${}^{0}-C_{4}H_{9}^{t}$$

$${}^{0}-C_{4}H_{9}^{t}$$

$${}^{0}-C_{4}H_{9}^{t}$$

$${}^{1}H_{25}C_{12}$$

$${}^{1}H_{17}C_{8}-0$$

$${}^{1}H_{17}C_{8}-0$$

$${}^{1}H_{21}C_{10}-0$$

$${}^{1}H_{21}C_{10}-0$$

$${}^{1}H_{21}C_{10}-0$$

$${}^{1}H_{22}C_{12}-0$$

$${}^{1}H_{23}C_{12}-0$$

$${}^{1}H_{25}C_{12}-0$$

$${}^{1}H_{25}C_{12}-0$$

$${}^{1}H_{25}C_{12}-0$$

$${}^{1}H_{25}C_{12}-0$$

$${}^{1}H_{25}C_{12}-0$$

$${}^{1}H_{25}C_{12}-0$$

$${}^{1}H_{25}C_{12}-0$$

$${}^{1}H_{25}C_{12}-0$$

【0187】 【化48】

[0188] [化49]

$$(A-1-17)$$
 $O-C_4H_9^t$
 $O-C_4H_9^t$
 $O-C_4H_9^t$
 $O-C_4H_9^t$
 $O-C_4H_9^t$
 $O-C_4H_9^t$

$$^{\circ}$$
 $^{\circ}$ $^{\circ}$

$$C_4H_9^t$$
 $C_4H_9^t$
 $C_4H_9^t$

[0189]

【化50】

72

-SO₃

$$C_4H_9^t$$
 OH $C_4H_9^t$

$$C_4H_9^t$$
 $C_4H_9^t$ $C_4H_9^t$ $C_4H_9^t$

$$C_4H_9^{t}$$
 $H_{17}C_8$
 $H_{17}C_8$

$$O-C_4H_9^t$$
 $H_9C_4-O-S^*$
 $O-C_4H_9^t$
 $O-C_4H_9^t$
 $O-C_4H_9^t$
 $O-C_4H_9^t$
 $O-C_4H_9^t$

$$O-C_4H_9^n$$

$$^nH_9C_4-O-SO_3^-$$
(A-1-28)

【0190】 【化51】

73

【0191】 【化52】

$$O-CH_3$$
 $O-C_4H_9^n$
 $O-C_4H_$

$$C_4H_9^t$$
 $O-C_4H_9^n$
 $PH_9C_4-O-PO_3$
 $O-C_4H_9^n$
 O

$$\begin{array}{c} CI \\ O - C_4 H_9^n \\ -S^+ \\ O - SO_3^- \end{array}$$

76

HO
$$OH$$

$$O-C_4H_9^n$$

$$(A-1-33)$$

$$^{\circ}_{H_{9}C_{4}}$$
 $^{\circ}_{H_{17}C_{8}}$ $^{\circ}_{H_{17}C_{8}}$ $^{\circ}_{H_{17}C_{8}}$ $^{\circ}_{H_{17}C_{8}}$ $^{\circ}_{H_{17}C_{8}}$

$$^{\circ}_{H_9C_4}$$
 $^{\circ}_{SO_3}$ $^{\circ}_{H_9C_4}$ $^{\circ}_{SO_3}$ $^{\circ}_{A-1-37}$ $^{\circ}_{A-1-37}$

$$^{i}H_{21}C_{10}-0$$
 $-S0_{3}$
 $(A-1-38)$

[0192]

【化53】

78

$$O-C_4H_9^n$$
 $O-C_4H_9^n$
 $O-C_4H_9^n$
 $O-C_4H_9^n$

$$CH_3$$
 $t_{H_9C_4}$
 $t_{H_9C_4}$

【0193】 【化54】

$$SO_3$$
 $i_{H_{17}C_8-0}$
 $O-C_8H_{17}$
 $(A-1-45)$

82

$$^{\circ}$$
 $^{\circ}$ $^{\circ}$

[0195]

【化56】

【0196】 【化57】

86

$$H_5C_2O - O - S^* CO_2C_2H_5$$
(A-1-61)

$$H_8C_3O - O_-S^+ CO_2C_3H_8$$

(A-1-62)

$$H_9C_4O - O - S^+ CO_2C_4H_9$$
(A-1-63)

[0198]

40

【化59】

[0199]

【化60】

(A-2-10)

$${}^{t}H_{9}C_{4} \longrightarrow I^{*} \longrightarrow C_{4}H_{9}^{t}$$

$${}^{t}H_{21}C_{10} - 0 \longrightarrow SO_{3}^{-}$$

$${}^{t}H_{17}C_{8} - 0 \longrightarrow SO_{3}^{-}$$

$${}^{t}H_{9}C_{4} \longrightarrow SO_{3}^{-}$$

$${}^{t}H_{17}C_{8} \longrightarrow SO_{3}^{-}$$

$${}^{t}H_{17}$$

[0200]

O-C8H17 O-C'H' (A-2-19) (A-2-20) O-C4H9n O-C4H9n $O-C_4H_9^n$ (A-2-21) (A-2-22)O-C4H9n O-C4H9n ⁿH₉C₄-O-(A-2-24)(A-2-23) ⁵H₁₇C₈ tH₉C₄ -SO₃ -SO₃ · *H₁₇C₈ (A-2-26) (A-2-25)

[0201]

30

【化62】

93

$$H_{3}C - O \longrightarrow I^{*} \longrightarrow O - CH_{3}$$
 $H_{9}C_{4} \longrightarrow SO_{3}^{*}$
 $H_{9}C_{4} \longrightarrow C_{4}H_{9}^{*}$
 $H_{17}C_{8} - O \longrightarrow SO_{3}^{*}$
 $H_{21}C_{10} - O \longrightarrow SO_{3}^{*}$
 $H_{17}C_{8} - O \longrightarrow SO_{3}^{*}$

【0202】 【化63】

(A-2-33)

(A-2-34)

$${}^{t}H_{9}C_{4} \longrightarrow {}^{t} \longrightarrow {}^{t}C_{4}H_{9}{}^{t} \longrightarrow {}^{t}H_{17}C_{8} \longrightarrow {}^{t}H_{17$$

[0203]

【化64】

$$H_{3}C-O-CH_{3}$$
 SO_{3}
 $IH_{17}C_{8}-O-C_{8}H_{17}^{i}$
 $(A-2-45)$

[0204]

【化65】

40

$$H_{3}C$$
 CH_{3}
 $H_{3}C$
 CH_{3}
 CH_{3}

$$H_3CO$$
 $-I$ $-I$ $-OCH_3$ $-I$ $-I$ $-C_2H_5$ $-C_2H_5$

$$^{i}C_{3}H_{7}^{i}$$
 $^{i}C_{3}H_{7}^{i}$
 $^{i}C_{3}H_{7}^{i}$

【化66】

[0205]

102

[0206]

【化67】

40

[0207]

【化68】

106

$$C1$$
 $S+S-S-S+S+SO_3$
 $S+S+SO_3$
 $S+S+SO_3$
 $S+S+SO_3$
 $S+S+SO_3$

$$^{i}H_{21}C_{10}-O ^{i}SO_{3}$$
 $^{i}A-3-8$

[0208]

30 【化69】

108

$$CH_3$$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 $CH_{17}C_8-O$
 $C_8H_9^t$
 CH_3
 CH

$$^{i}H_{25}C_{12}-0$$
 $-(A-3-11)$

[0209]

【化70】

110

$$CH_3$$
 $O-C_4H_9^n$
 $-S-S^+$
 $^nH_9C_4-O-SO_3^ (A-3-17)$

$$O-CH_{3}$$

$$O-C_{4}H_{9}^{n}$$

$$S-S-S-S-S-SO_{3}^{-}$$

$$(A-3-18)$$

[0210]

30 【化71】

111

$$C_4H_9^t$$
 $O-C_4H_9^n$
 $O-C_4H_9^n$

(A-3-23)

·[0211]

【化72】

114

(A-3-28)

[0212]

【化73】

$$\begin{array}{c} SO_{3}^{-} \\ -S - \\ -S$$

$$C_2H_5$$

$$C_2H_5$$

$$C_2H_5$$

$$C_2H_5$$

$$C_2H_5$$

$$C_3H_7^i$$
 $C_3H_7^i$
 $C_3H_7^i$
 $C_3H_7^i$

[0213]

$$OCH_3$$

$$OCH_3$$

$$OCH_3$$

$$OCH_3$$

【化74】

$$OC_2H_5$$
 OC_2H_5
 OC_2H_5
 OC_2H_5

【0214】尚、具体例中、nは直鎖、sは第2級、t は第3級、iは分岐であることを示す。

【0215】一般式 (A-1)~ (A-3)で表される 化合物は、例えば対応するC1-塩(一般式(A-1) ~ (A-3) でX·をC1· で置換した化合物) と、X-Y・で表わされる化合物 (X-は一般式 (A-1)~(A 50 一般式 (A-4)、 (A-5) において、R11~R13、

ー3)の場合と同義であり、Y・はH・、Na・、K・、N H₄⁺、N (C H₃)₄⁺ 等のカチオンを示す。) とを水溶 液中で塩交換させることにより合成できる。

【0216】一般式(A-4)、(A-5)で示される 酸発生剤

 $R_{14} \sim R_{16}$ におけるアルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子は前記 $R^1 \sim R^5$ のものと同様のものを具体例として挙げることができる。 R_6 、 X は、前記と同義である。

【0217】また、1、m、nが各々2又は3の場合、 2又は3個のR11~R13 あるいはR14~R16 のうちの各 々の2個が互いに結合して、炭素環、複素環又は芳香環 を含む5~8個の元素からなる環を形成してもよい。 【0218】以下に、一般式 (A-4) で表される化合物の具体例 $(A-4-1) \sim (A-4-28)$ 、一般式 (A-5) で表される化合物の具体例 $(A-5-1) \sim (A-5-30)$ を示すが、これに限定されるものではない。

[0219] 【化75】

[0220]

【化76】

[0221]

【化77]

122 (A-4-12) (A-4-14)

[0222]

【化78】

124 4H17C8 tH₉C₄. tH₉C₄-(A-4-17) /ºH₁₇C₈-0-(A-4-18) $/^{n}H_{21}C_{10}-O$ (A-4-19)

[0223]

【化79】

[0224]

 $\begin{array}{c|c} & & & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & \\ &$

[0225]

$$^{i}H_{25}C_{12}$$
 $S = S - S_{-}$
 $(A-5-3)$
 $^{i}H_{25}C_{12}$
 $S = S_{-}$
 $(A-5-4)$
 $^{i}H_{25}C_{12}$
 $S = S_{-}$
 $(A-5-4)$

$$^{i}H_{17}C_{8}-0$$
 $^{-5-7}$

[0226]

[0227]

132

[0228] [化84]

【化85】

【0231】尚、具体例中、nは直鎖、sは第2級、tは第3級、iは分岐であることを示す。

【0232】一般式 (A-4)、(A-5)で表される化合物は、例えば対応するC1⁻塩(一般式 (A-4)、(A-5)でX⁻をC1⁻で置換した化合物)と、X⁻Y⁻で表わされる化合物(X⁻は一般式 (A-4)、(A-5)の場合と同義、Y⁻はH⁻、Na⁻、K⁻、NH (CH3) (**等のカチオンを示す。)とを水溶液中で塩交換させることにより合成できる。

【0233】一般式(A-6)で表される酸発生剤 前記一般式(A-6)におけるY及びR31~R51の直鎖、分岐、環状アルキル基としてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、secーブチル基、tーブチル基、ヘキシル基、オクチル基のような炭素数1~20個の直鎖又は分岐アルキル基及びシクロプロピル基、シクロベンチル基又はシクロヘキシル基等の環状アルキル基が挙げられる。アルキル基の好ましい置換基としてはアルコキシ基、アシル基、アシロキシ基、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などが挙げられる。

【0234】また、Yのアラルキル基としてはベンジル基もしくはフェネチル基のような炭素数7~12個のアラルキル基が挙げられる。アラルキル基の好ましい置換基としては、炭素数1~4の低級アルキル基、炭素数1~4の低級アルコキシ基、ニトロ基、アセチルアミノ基、ハロゲン原子などが挙げられる。

【0235】R31~R51のアルコキシ基としてはメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、nーブトキシ基、イソプトキシ基、secーブトキシ基、tーブトキシ基、オクチルオキシ基、ドデシルオキシ基の 30ような炭素数1~20個のアルコキシ基又はエトキシエトキシ基などの置換基を有するアルコキシ基が挙げられる。

【0236】アシル基としてはアセチル基、プロピオニル基、ベンゾイル基などが挙げられる。アシルアミノ基としてはアセチルアミノ基、プロピオニルアミノ基、ベンゾイルアミノ基などが挙げられる。スルホニルアミノ基としてはメタンスルホニルアミノ基、エタンスルホニルアミノ基など炭素数1~4個のスルホニルアミノ基、pートルエンスルホニルアミノ基のような置換または無40置換のベンゼンスルホニルアミノ基があげられる。

【0237】アリール基としてはフェニル基、トリル 基、ナフチル基などが挙げられる。アルコキシカルボニ ル基としてはメトキシカルボニル基、エトキシカルボニ ル基、エトキシエトキシカルボニル基、オクチルオキシ カルボニル基、ドデシルオキシカルボニル基などの炭素 数2~20個のアルコキシカルボニル基があげられる。 【0238】アシロキシ基としてはアセトキシ基、プロ パノイルオキシ基、オクタノイルオキシ基、ベンゾイル オキシ基のような炭素数 2~20個のアシロキシ基があ 50 げられる。

【0239】アラルキル基としては置換または無置換ペンジル基、置換または無置換フェネチル基などの炭素数7~15個のアラルキル基があげられる。アラルキル基の好ましい置換基としては前記にあげたものと同じものがあげられる。

【0240】R₃₁~R₅₁においては、R₃₁~R₃₅、R₃₆~R₄₂及びR₄₃~R₅₁はそれぞれの群のうちの2つが結合して炭素及び/又はヘテロ原子からなる5~8員環を形成していもよい。このような5~8員環としては、例えばシクロヘキサン、ピリジン、フラン又はピロリジンがあげられる。

【0241】また、X、Yは別のイミドスルホネート化合物の残基と結合していてもよく、2量体、3量体を形成していても良い。別のイミドスルホネートとしては、一般式(A-6)で表される化合物で、X又はYのところで1価の基になったものがあげられる。

【0242】Xのアルキレン基としては、直鎖又は分岐の炭素数1~10個のアルキレン基あるいはヘテロ原子を含んでいてもよい単環又は多環の環状アルキレン基が挙げられる。

【0243】直鎖又は分岐のアルキレン基としてはメチレン基、エチレン基、プロピレン基又はオクチレン基などがあげられる。アルキレン基の好ましい置換基としてはアルコキシ基、アシル基、ホルミル基、ニトロ基、アシルアミノ基、スルホニルアミノ基、ハロゲン原子、アリール基、アルコキシカルボニル基が挙げられる。ここで挙げたアルコキシ基、アシル基、ニトロ基、アシルアミノ基、スルホニルアミノ基、アリール基、アルコキシカルボニル基はR31~R51で挙げたものと同義である。ハロゲン原子としてはフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を挙げることができる。

【0244】環状アルキレン基としてはシクロペンチレン基、シクロヘキシレン基、などの炭素数4~8個の単環シクロアルキレン基、7ーオキサビシクロ〔2.2.1〕ヘプチレン基などの炭素数5~15個の多環シクロアルキレン基が挙げられ、シクロアルキレン基の好ましい置換基としては、炭素数1~4個のアルキル基、アルコキシ基、アシル基、ホルミル基、ニトロ基、アシルアミノ基、スルホニルアミノ基、ハロゲン原子、アリール基、アルコキシカルボニル基が挙げられる。

【0245】ここで挙げたアルコキシ基、アシル基、ニトロ基、アシルアミノ基、スルホニルアミノ基、アリール基、アルコキシカルボニル基はR31~R51で挙げたものと同義である。ハロゲン原子としてはフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を挙げることができる。【0246】アリーレン基としてはフェニレン基、ナフチレン基等が挙げられる。アリーレン基の好ましい置換基としてはアルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、アシル基、ホルミル基、ニトロ基、アシルアミノ

基、スルホニルアミノ基、ハロゲン原子、アリール基、 アルコキシカルボニル基が挙げられる。

【0247】ここで挙げたアルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、アシル基、ホルミル基、ニトロ基、アシルアミノ基、スルホニルアミノ基、アリール基、アルコキシカルボニル基はR31~R51で挙げたものと同義である。ハロゲン原子としてはフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を挙げることができる。

【0248】アルケニレン基としては炭素数2~4個のアルケニレン基があげられ、例えばエテニレン基、ブテ 10 ニレン基等が挙げられ、アルケニレン基の好ましい置換基としてはアルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、アシル基、ホルミル基、ニトロ基、アシルアミノ基、スルホニルアミノ基、ハロゲン原子、アリール基、アルコキシカルボニル基が挙げられる。ここで挙げたアルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、アシル基、ホルミル基、ニトロ基、アシルアミノ基、スルホニルアミノ基、アリール基、アルコキシカルボニル基はR 31 ~R51 で挙げたものと同義である。ハロゲン原子としてはフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を挙 20 げることができる。

【0249】環状アルケニレン基としてはシクロペンテニレン基、シクロヘキセニレン基、などの炭素数4~8個の単環シクロアルケニレン基、7ーオキサビシクロ〔2.2.1〕ヘプテニレン基、ノルボルネニレン基などの炭素数5~15個の多環シクロアルケニレン基が挙げられる。

【0250】アラルキレン基としては、トリレン基、キシリレン基などが挙げられ、その置換基としてはアリーレン基で挙げた置換基をあげることができる。

【0251】以下に、これらの一般式 (A-6) で表される化合物の具体例 (A-6-1) ~ (A-6-49) を示すが、これに限定されるものではない。

[0252]

【化87】

$$N-OSO_2$$
 $N-OSO_2$
 $N-OSO_2$

[0253] [化88]

40

20

139

$$\begin{array}{c}
O \\
N - OSO_2 - O \\
O \\
(A-6-6)
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
O \\
N - OSO_2 - O \\
O \\
(A-6-8)
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
O \\
N - OSO_2 - Me
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
O \\
(A-6-9)
\end{array}$$

$$0 \\ N - OSO_2 - Et$$

$$0 \\ (A-6-10)$$

[0254] [化89] O OHC N-OSO₂-O

140

O . (A-6-11)

$$\begin{array}{c}
0\\
N-OSO_2-\longrightarrow-NHSO_2Me\\
0\\
(A-6-13)
\end{array}$$

【0255】 【化90】

30

20

141

$$\begin{array}{c}
O \\
N - OSO_2 - CH_2 - O \\
O \\
(A-6-16)
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
O & Me \\
N - OSO_2 - Me \\
O & Me \\
(A-6-17)
\end{array}$$

Me
$$N-OSO_2$$
 OMe $(A-6-18)$

t-Bu
$$N-OSO_2$$
 $N-OSO_2$ NHAc $O(A-6-19)$

$$\begin{array}{c|c}
Cl & O \\
N-OSO_2 & O \\
Cl & O \\
(A-6-20)\end{array}$$

[0256] [化91] 142

t-Bu
$$N-OSO_2$$
 OMe $(A-6-21)$

Me
$$N-OSO_2-Me$$

$$(A-6-22)$$

$$\begin{array}{c}
O \\
N - OSO_2 - \bigcirc - Me
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(A-6-23)
\end{array}$$

$$N-OSO_2$$
 $N-OSO_2$
 $(A-6-25)$

【0257】 【化92】

30

20

30

143

$$\begin{array}{c} O \\ N - OSO_2 - n - C_8H_{17} \\ O \\ (A - 6 - 26) \end{array}$$

$$\begin{array}{c} Me \\ N - OSO_2 - O \\ O \\ (A - 6 - 27) \end{array}$$

$$\begin{array}{c} O \\ (A - 6 - 27) \end{array}$$

$$(A-6-28)$$
 $N-OSO_2 - O-NO_2$
 $(A-6-29)$

$$\begin{array}{c}
O \\
N - OSO_2 - O \\
O \\
(A-6-30)
\end{array}$$

$$N-OSO_2$$
—OMe (A-6-31)

【0258】 【化93】 $\begin{array}{c|c}
O & Me \\
N - OSO_2 - Me \\
O & Me \\
(A-6-32)
\end{array}$

144

$$\begin{array}{c}
O \\
N - OSO_2 - Me
\end{array}$$
(A-6-33)

NOSO₂—OCH₂CH₂OCH₂CH₃

$$O$$
(A-6-35)

【0259】 【化94】

$$n-C_8H_{17}$$
 $N-OSO_2$
 $N-OSO_2$
 $N-OSO_2$

$$\begin{array}{c}
O \\
N - OSO_2 - O \\
O \\
(A-6-38)
\end{array}$$

Me
$$O$$
 $N-OSO_2$
 O
 $(A-6-39)$

$$\begin{array}{c} Ph \\ N-OSO_2 - - - - Me \end{array}$$

$$(A-6-40)$$

【0261】一般式(A-6)で表される化合物は、G. F.Jaubert 著、Ber. 28,360(1895)の方法、D.E.Ames等 30 著、J.Chem.Soc..3518(1955)の方法、あるいはM.A.Stol berg等著、J.Am. Chem.Soc..79,2615(1957) の方法等に 従い合成されたNーヒドロキシイミド化合物とスルホン 酸クロリドとを塩基性条件下、例えばL.Bauer 等著、J. Org.Chem. .24,1294(1959) の方法に従い合成することが 可能である。

【0262】一般式(A-7)で表される酸発生剤 一般式 (A-7) 中、Arı、Arzは、同一または異な って、置換もしくは未置換のアリール基を示す。

【0263】ここで、アリール基としては、フェニル 基、トリル基、ナフチル基などが挙げられる。アリール 基の置換基としては、アルキル基、シクロアルキル基、 アルコキシ基、アシル基、ホルミル基、ニトロ基、アシ ルアミノ基、スルホニルアミノ基、ハロゲン原子、アリ ール基、アルコキシカルボニル基が挙げられる。

【0264】ここで挙げたアルキル基、シクロアルキル 基、アルコキシ基、アシル基、ホルミル基、ニトロ基、 アシルアミノ基、スルホニルアミノ基、アリール基、ア ルコキシカルボニル基は上記R31~R51で挙げたものと 同義である。ハロゲン原子としてはフッ素原子、塩素原 50 子、臭素原子、ヨウ素原子を挙げることができる。

【0265】一般式(A-7)で表される酸発生剤の具 体例としては以下に示す化合物(A-7-1)~(A-7-14)が挙げられるが、これらに限定されるもので はない。

[0266] 【化96】

20

149

$$CI \longrightarrow SO_2 - SO_2 \longrightarrow CI$$

$$(A-7-1)$$

$$H_3C \longrightarrow SO_2 - SO_2 \longrightarrow CH_3$$

$$(A-7-2)$$

$$H_3CO \longrightarrow SO_2 - SO_2 \longrightarrow CI$$

$$(A-7-3)$$

$$H_3C \longrightarrow SO_2 - SO_2 \longrightarrow CI$$

$$(A-7-4)$$

$$F_3C \longrightarrow SO_2 - SO_2 \longrightarrow CF_3$$

$$(A-7-6)$$

$$H_5C_2O \longrightarrow SO_2 - SO_2 \longrightarrow CI$$

$$(A-7-6)$$

$$GA-7-7$$

$$SO_2 - SO_2 \longrightarrow CI$$

$$(A-7-8)$$

[0267] [化97] 150

$$SO_2 - SO_2 - CH_3$$

$$(A-7-9)$$

$$SO_2 - SO_2 - OCH_3$$

$$CI - SO_2 - SO_2 - OCH_3$$

$$(A-7-11)$$

$$H_3C - SO_2 - SO_2 - OCH_3$$

$$(A-7-12)$$

$$F - F - F - F - F$$

$$(A-7-13)$$

$$H - SO_2 - SO_2 - OCH_3$$

(A-7-14)

【0268】上記一般式(A-7)で表される酸発生剤 の合成としては、ジー. シー. デンサー. ジュニア. ら 著「ジャーナル オブ オルガニックケミストリー」 (G.C. Denser, Jr. ら著、「Journal of Organic Chemi stry」) 31、3418~3419 (1966) 記載の方法、テー. ピ 一. ヒルドイッチ著「ジャーナル オブ ザ ケミカル ソサイアティ」(T.P. Hilditch著「Journal of the C he mi cal Society J) 93、1524~1527 (1908) 記載の 方法、あるいはオー、ヒンズベルク著「ベリヒテ デア ドイチェン ヘミシエ ゲゼルシャフト」(0. Hinsbe rg著、「Berichte der Deutschen Chemischen Gesellsc haft」) 49、2593~2594 (1918) 記載の方法等にしたが 40 い合成できる。すなわち、硫酸水溶液中において、硫酸 コバルトを用い、一般式(a)で示されるスルフィン酸 より合成する方法、キサントゲン酸エチルを用い、一般 式(b)で示されるスルホン酸クロリドより合成する方 法、あるいは塩基性条件下、一般式(a)で示されるス ルフィン酸と一般式(b)で示されるスルホン酸クロリ ドとを合成する方法等が挙げられる。

$$[0269] Ar_1 - SO_2H$$
 (a)
 $Ar_2 - SO_2C_1$ (b)

(ここで、Arı、Ar₂は一般式(A-7)で定義されたものと同一の意味である。)

本発明においては、上記一般式 (A-1)~ (A-7) で表される酸発生剤のうち、一般式(A-1)~(A-5) で表される酸発生剤が好ましく、より好ましくは一 般式(A-1)~(A-4)で表される酸発生剤であ る。これにより、解像度、感度が一層優れるようにな る。

【0270】本発明において、酸発生剤(好ましくは一 般式 (A-1) ~ (A-7) で表される化合物) の組成 物中の含量は、全組成物の固形分に対し、0.1~25 重量%が好ましく、より好ましくは1~15重量%、更 10 に好ましくは2~10重量%である。

【0271】また、酸発生剤(b)が、活性放射線の照 射によりフッ素含有スルホン酸を発生する化合物 a であ ることも好ましい。〔a〕化合物aとしては、例えば、 下記の一般式(PAG3)で表されるヨードニウム塩、 又は一般式(PAG4)で表されるスルホニウム塩を挙 げることができる。

[0272]

【化98】 (PAG3)

【0273】式中、Arl、Arlは、各々独立に、置換 もしくは未置換のアリール基を示す。 R²⁰³ 、 R²⁰⁴ 、 R 205 は、各々独立に、置換もしくは未置換のアルキル 基、アリール基を示す。

【0274】 Z・は、少なくとも1つのフッ素原子を有 するスルホン酸アニオンを示す。

【0275】またR²⁰³、R²⁰⁴、R²⁰⁵のうちの2つお よびAr¹、Ar²はそれぞれの単結合または置換基を介 して結合してもよい。

【0276】Ar¹、Ar²、R²⁰³、R²⁰⁴、R²⁰⁵とし てのアリール基としては、好ましくは、炭素数6~14 のアリール基、アルキル基としては、好ましくは炭素数 1~8のアルキル基である。

【0277】好ましい置換基としては、アリール基に対 しては炭素数1~8のアルコキシ基、炭素数1~8のア ルキル基、炭素数2~9のアルコキシカルボニル基、炭 素数2~9のアルキルカルボニルアミノ基、ニトロ基、 カルボキシル基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子及びフェ ニルチオ基であり、アルキル基に対しては炭素数1~8 のアルコキシ基、炭素数5~14のアリール基、炭素数 6~15のアリールカルボニル基、カルボキシル基及び ハロゲン原子を挙げることができる。

【0278】 2-のスルホン酸アニオンとしては、好ま しくは、少なくとも1つのフッ素原子を有する炭素数1 ~20の脂肪族炭化水素及び炭素数5~20の芳香族炭 化水素を挙げることができる。これらは置換基を有して 50 いてもよく、置換基としては、例えば、炭素数1~10 のフッ素置換していてもよいアルコキシ基、炭素数2~ 11のフッ素置換していてもよいアルコキシカルボニル 基、フェニルアミノ基、フェニルカルボニル基、ハロゲ ン原子、水酸基を挙げることができる。芳香族炭化水素 に対しては、さらに炭素数1~15のアルキル基を挙げ ることができる。

【0279】以下に具体例を挙げるが、これらに限定さ れるものではない。

[0280]

$$(1.99)$$

$$(VI-1)$$

$$I^+ CF_3(CF_2)_2SO_3^-$$
 (VI-3)

$$(VI-10)$$

[0281] 【化100】

153

$ \left(\right)$ $\left(\right)^{2}$ $\left(\right)^{1}$	CF₂HSO₃¯	(VI-11)	[0282]
			【化101】

$$(VI-13)$$

$$(VI-15)$$

$$(V_{1-16})$$

$$(VI-17)$$

$$F \longrightarrow F SO_3^- (VI-18)$$

155 156 $O-(n)C_8H_{17}$ $CF_3CF_2SO_3$ **(VI-21)** (VI-22) -NHCO(CH₂)₈CH₃ CF₃(CF₂)₃SO₃ **(VI-23)** -NHCO(CH₂)₈CH₃ CF₃(CF₂)₇SO₃(V1-24)CF₃(CH₂)₂SO₃ (V1-25)CF₃CH₂CH(CH₃)SO₃ (VI-26) CF₃CH₂CH(CF₃)SO₃ (V1-27)CH₃(CF₂)₇SO₃ (V1-28)CF₃(CF₂)₂O(CF₂)₂SO₃ (Y1-29)CF₃(CF₂)₂OCF(CF₃)SO₃ (V1-30)F[CF(CH₃)CF₂O]₂CF(CF₃)SO₃

[0283]

157 CF₃SO₃ **(VII-1)** CF₃CF₂SO₃ **(YII-2)** CF₃(CF₂)₂SO₃ (VII-3) CF₃(CF₂)₃SO₃ (VII-4) CF₃(CF₂)₇SO₃ (VII-5)

$$(\bigcirc) + s^{+} \qquad \bigcirc + SO_{3}^{-} \qquad (\forall 11-8)$$

$$(\bigcirc) + s^{+} \qquad \bigcirc + SO_{3}^{-} \qquad (\forall 11-9)$$

特開2003-177537 158 (VII-10) CF₂HSO₃ (VII-11) (VI I-12) CF₂CISO₃ CF₃CH(OH)SO₃ (VII-15) $(CF_3)_2C(OH)SO_3$ (VII-16)

CF₃(CF₂)₁₈SO₃

(VII-18)

[0285] 【化104】

160

nBuO
$$S$$
 CF_3CFHSO_3 $(VII-19)$

$$\bigcirc -S - \bigcirc -S^{+} CF_{3}SO_{3}^{-}$$
 (VII-23)

[0286]

30 【化105】

161

$$\bigcirc -s - \bigcirc -s + \bigcirc CF_3(CF_2)_3SO_3 - (VII-24)$$

$$O-s-O-s^*$$
 (CF₃)₂C(OH)SO₃ (VII-26)

$$- CF_3(CF_2)_7SO_3^- \qquad (YII-27)$$

$$CF_3(CF_2)_2SO_3^-$$
 (VII-28)

30

[0287]

【化106】

164

[0288]

166

$$(+ \bigcirc)_{3} \text{ s}^{+} \quad \text{CF}_{3}(\text{CF}_{2})_{3}\text{SO}_{3}^{-} \qquad (\text{VII}-36)$$

$$(+ \bigcirc)_{3} \text{ s}^{+} \quad \text{CF}_{3}(\text{CF}_{2})_{7}\text{SO}_{3}^{-} \qquad (\text{VII}-37)$$

$$(+ \bigcirc)_{3} \text{ s}^{+} \quad \text{F} \qquad -\text{SO}_{3}^{-} \qquad (\text{VII}-38)$$

$$(+ \bigcirc)_{3} \text{ s}^{+} \quad \text{F} \qquad -\text{SO}_{3}^{-} \qquad (\text{VII}-39)$$

$$(+ \bigcirc)_{3} \text{ s}^{+} \quad \text{Br} \qquad -\text{SO}_{3}^{-} \qquad (\text{VII}-40)$$

$$(+ \bigcirc)_{3} \text{ s}^{+} \quad \text{Br} \qquad -\text{SO}_{3}^{-} \qquad (\text{VII}-41)$$

$$(+ \bigcirc)_{3} \text{ s}^{+} \quad \text{Br} \qquad -\text{SO}_{3}^{-} \qquad (\text{VII}-42)$$

$$(+ \bigcirc)_{3} \text{ s}^{+} \quad \text{Br} \qquad -\text{SO}_{3}^{-} \qquad (\text{VII}-41)$$

[0289]

【化108】

168

$$CF_{2}CISO_{3}^{-} \qquad (VIII-44)$$

$$CF_{3}(CF_{2})_{3}SO_{3}^{-} \qquad (VIII-45)$$

$$CF_{3}(CF_{2})_{7}SO_{3}^{-} \qquad (VIII-46)$$

$$F \longrightarrow F \longrightarrow F \qquad (VIII-47)$$

$$F \longrightarrow F \qquad (VIII-48)$$

$$S^{+} \longrightarrow F \qquad (VIII-48)$$

[0290]

【化109】

【0291】化合物 a を使用する場合、活性放射線の照射により、フッ素原子を含有しないスルホン酸を発生する化合物、又は、活性放射線の照射により、カルボン酸を発生する化合物の少なくともいずれかを併用することが好ましい。

【0292】 [b] 化合物 a と併用することが好ましい 30 活性放射線の照射によりフッ素原子を含有しないスルホン酸を発生する化合物 (化合物 b) としては、例えば、

先の一般式 (PAG3) 及び (PAG4) において、Z-がフッ素原子を有しないスルホン酸アニオンであるヨードニウム塩及びスルホニウム塩を挙げることができる。

【0293】具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[0294]

 $F[CF(CF_3)CF_2O]_2CF(CF_3)SO_3$ (VII-56)

【化110】

171

$$(n)C_7H_{15} \longrightarrow (n)C_7H_{15} \qquad (PAG3-10)$$

$$H_3 \longrightarrow OCH_3 \qquad (PAG3-11)$$

[0296]

【化112】

[0298] [化114]

[0297]

,SO₃

(/+(CH₂)7SO

(PAG3-28)
$$(+ CH_3(CH_2)_{10}SO_3^{-1} + CH_3(CH_2)_{10}SO_3^{-1}$$

(PAG3-29)

$$\left(\begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \end{array}\right) \begin{array}{c} \\ \\ \end{array}\right)_{2} I^{+} \qquad CH_{3}(CH_{2})_{12}SO_{3}^{-}$$

20

10

 \rightarrow 1 CH₃(CH₂)₁₄SO₃

(PAG3-31)

$$C_4H_9$$
 C_4H_9
 C_4H_9
 C_4H_9

[0299]

【化115】

(PAG4-25)

【0302】また、下記一般式(PAG5)で表される ジスルホン誘導体又は一般式(PAG6)で表されるイ ミノスルホネート誘導体を挙げることができる。

[0303]

【化118】

 $Ar^3 - SO_2 - SO_2 - Ar^4$ [0306] 【化119】 (PAG5) (PAG6) (PAGS-1) (PAGS-2) (PAG5-3) (PAG5-4) (PAG5-6) sor-so (PAG5-7) (PAG5-8) 50,- SO, (PAG5-9) (PAG5-10) нς (PAG\$-11) (PA65-12)

(PAG5-14)

[0307]

50 【化120】

(PAG5-15)

【0304】式中、Ar³、Ar⁴は各々独立に置換もし くは未置換のアリール基を示す。 R 206 は置換もしくは 未置換のアルキル基、アリール基を示す。Aは置換もし くは未置換のアルキレン基、アルケニレン基、アリーレ ン基を示す。

【0305】具体例としては以下に示す化合物が挙げら れるが、これらに限定されるものではない。

[0308]

[0309]

【化122】

(PAG6-22)

【0310】また、下記一般式 (PAG7) で表される ジアゾジスルホン誘導体を挙げることができる。

[0311]

【化123】

【0312】式中、Rは、直鎖、分岐又は環状アルキル基、あるいは置換していてもよいアリール基を表す。

【0313】具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[0314]

【化 1 2 1 】 O N-O-SO₂-CO₃CH₃ O (PAGE-20)

【化124】

30

40

【0315】上記〔a〕及び〔b〕で説明した化合物 50 は、過ヨウ素酸塩を用いて芳香族化合物を反応させ、得 られたヨードニウム塩を対応するスルホン酸に塩交換することにより合成可能である。

【0316】また、アリールマグネシウムプロミドなどのアリールグリニャール試薬と置換又は無置換のフェニルスルホキシドを反応させ、得られたトリアリールスルホニウムハライドを対応するスルホン酸と塩交換する方法で合成できる。また、置換又は無置換のフェニルスルホキシドと対応する芳香族化合物をメタンスルホン酸/五酸化二リンあるいは塩化アルミニウムなどの酸触媒を用いて縮合、塩交換する方法、ジアリールヨードニウム塩とジアリールスルフィドを酢酸銅などの触媒を用いて縮合、塩交換する方法などによって合成できる。

【0317】塩交換は、いったんハライド塩に導いた後に酸化銀などの銀試薬を用いてスルホン酸塩に変換する方法、あるいはイオン交換樹脂を用いることでも塩交換できる。また、塩交換に用いるスルホン酸あるいはスルホン酸塩は、市販のものを用いるか、あるいは市販のスルホン酸ハライドの加水分解などによって得ることができる。

【0318】化合物 a と併用することが好ましい活性放 20 射線の照射によりカルボン酸を発生する化合物としては、フッ素非含有カルボン酸を発生する化合物 c 及びフッ素含有カルボン酸を発生する化合物 d を挙げることができる。

【0319】〔c〕化合物aと併用することが好ましい活性放射線の照射によりフッ素非含有カルボン酸を発生する化合物cとしては、例えば、下記一般式(AI)~(AV)で示される化合物を挙げることができる。

[0320]

【化125】

182 R₃₀₄ R₃₀₃ R₃₀₇ R₃₀₆ R₃₀₅ F₃₀₁ R₃₀₈ $\mathbf{x}^{\mathsf{-}}$ (AI) R₃₁₅ R₃₀₉ R₃₁₀ R₃₁₁ R₃₁₄ R₃₁₂ R₃₁₃ R₃₁₇ R318 R325 R₃₂₀ P322 $\mathbf{X}^{\mathsf{-}}$ \mathbf{X}^{-} (AII) R₃₂₃ R₃₂₆ R₃₁₈ R₃₁₉ R₃₃₃ R₃₃₄ R₃₂₉ R₃₂₈ R₃₃₀ R335 (IIIA) R₃₃₂ R₃₃₇ R₃₃₆

【0321】上記式において、R301 ~R337 は、各々独立に水素原子、直鎖、分岐あるいは環状アルキル基、直鎖、分岐あるいは環状アルコキシ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、または-S-R0基を表す。R0は直鎖、分岐、環状アルキル基またはアリール基を表す。

(AV)

【0322】Ra、Rbは、各々独立に水素原子、ニトロ基、ハロゲン原子、置換基を有していてもよい、アルキル基、アルコキシ基を表す。Rc、Rdは、各々独立にハロゲン原子、置換基を有していてもよい、アルキル基又はアリール基を表す。RcとRdとが結合して芳香環、単環あるいは多環の環状炭化水素(これらの環内には酸素原子、窒素原子を含んでいてもよい)を形成してもよい。Y1、Y2は、炭素原子を表し、Y1ーY2結合は、単結合でも2重結合でもよい。上記X-は、下記式で示されるカルボン酸化合物がアニオンになったものを表す。

【0323】X1、X2は、各々独立に、下記式で示されるカルボン酸化合物がカルボキシル基部分でエステル基となったものを表す。

[0324]

(AIV)

【化126】

$$(R_{338})_{m}$$
 R_{339}
 C
 C
 $(R_{340})_{n}$

$$(R_{340})_{q}$$
 $(R_{338})_{p}$ $(R_{338})_{p}$ $(R_{338})_{n}$ $(R_{340})_{n}$ $(R_{338})_{p}$ $(R_{338})_{p}$ $(R_{338})_{p}$ $(R_{340})_{n}$ $(R_{338})_{p}$ $(R_{338})_{p}$ $(R_{338})_{p}$ $(R_{340})_{n}$ $(R_{338})_{p}$ $(R_{338})_{$

[0325]

$$(R_{398})_{p}$$
 $(R_{340})_{q}$ $(C7)$ $(R_{340})_{p}$ $(R_{340})_{p}$

$$(R_{338})_{m}$$
 $(R_{340})_{q}$ $(C8)$ $(R_{340})_{p}$ $(R_{339})_{z}$ $(C8)$

$$(R_{338})_{m}$$
 $(R_{340})_{q}$
 $(R_{339})_{Z}$
 $(R_{339})_{Z}$
 $(R_{339})_{Z}$
 $(R_{340})_{q}$
 $(R_{340})_{q}$

$$(R_{338})$$
 $(R_{340})_n$
 $(R_{339})_z$
 $(R_{339})_z$

【0326】上記式中、R338 は、炭素数1~30の直鎖状、分岐状あるいは環状のアルキル基(ここで、アルキル基の鎖中に酸素原子、窒素原子を含んでいてもよい)、炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルケニル基、炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキニル基、炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキニル基、炭素数1~20の直鎖状、分岐 30 状あるいは環状のアルコキシル基、前記アルキル基の水素原子の少なくとも一部がハロゲン原子および/または水酸基で置換された基、前記アルケニル基の水素原子の少なくとも一部がハロゲン原子および/または水酸基で置換された基、あるいは炭素数6~20の置換もしくは非置換のアリール基を示す。ここで、アリール基の置換基としてはアルキル基、ニトロ基、水酸基、アルコキシ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、ハロゲン原子を挙げることができる。

【0327】R339 は、単結合あるいは、炭素数1~20の直鎖状、分岐状あるいは環状のアルキレン基(ここで、アルキレン基の鎖中に酸素原子、窒素原子を含んでいてもよい)、炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルケニレン基、前記アルキレン基の水素原子の少なくとも一部がハロゲン原子および/または水酸基で置換された基、前記アルケニレン基の水素原子の少なくとも一部がハロゲン原子で置換された基、あるいは炭素数2~20のアルコキアルキレン基を示し、複数存在するR338、R339 は相互に同一でも異なってもよい。

【0328】R340 は水酸基またはハロゲン原子を示

し、複数存在する R_{340} は相互に同一でも異なってもよい。 m、 n 、 p および q は各々独立に、 0 ~ 3 の整数で、 $m+n \le 5$ 、 $p+q \le 5$ である。 z は 0 または 1 である。

【0329】前記一般式 (AI) ~ (AV) における、R301 ~ R337、Ra、Rb、Rc、Rd、Roにおける直鎖、分岐アルキル基としては、置換基を有してもよい、メチル基、エチル基、プロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基のような炭素数1~4個のものが挙げられる。環状アルキル基としては、置換基を有してもよい、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基のような炭素数3~8個のものが挙げられる。

【0330】 $R_{301} \sim R_{337}$ 、 R_a 、 R_b のアルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、ヒドロキシエトキシ基、プロポキシ基、n-プトキシ基、イソプトキシ基、 s_c e_c e_c

【0331】R₃₀₁ ~R₃₃₇ 、Ra、Rb、Rc、Rdの ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原 子、沃素原子を挙げることができる。

【0332】Ro、Rc、Rdのアリール基としては、フェニル基、トリル基、メトキシフェニル基、ナフチル基のような置換基を有してもよい炭素数6~14個のものが挙げられる。

50 【0333】これらの置換基として好ましくは、炭素数

1~4個のアルコキシ基、ハロゲン原子(フッ素原子、 塩素原子、沃素原子)、炭素数6~10個のアリール 基、炭素数2~6個のアルケニル基、シアノ基、ヒドロ キシ基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、ニト ロ基等が挙げられる。

【0334】RcとRdとが結合して形成する、芳香環、単環あるいは多環の環状炭化水素(これらの環内には酸素原子、窒素原子を含んでいてもよい)としては、ベンゼン構造、ナフタレン構造、シクロヘキサン構造、ノルボルネン構造、オキサビシクロ構造等が挙げられる。

【0335】本発明で使用される一般式(AI)~(AII)で表されるスルホニウム、ヨードニウム化合物は、その対アニオンX・として、上記式(CI)~(CI)で示されるカルボン酸化合物のうち少なくとも1種の化合物のカルボキシル基(-COOH)がアニオン(-COO-)となったものを含む。

【0336】本発明で使用される一般式(AIV)~(AV)で表される化合物は、置換基X1、X2として、上記式(C1)~(C10)で示されるカルボン酸化合 20物のうち少なくとも1種の化合物のカルボキシル基(-COOH)がエステル基(-COO-)となった置換基を含む。

【0337】R338 における、炭素数1~30の直鎖状、分岐状あるいは環状のアルキル基(ここで、アルキル基の鎖中に酸素原子、窒素原子を含んでいてもよい)としては、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、シクロヘキシル、ドデシル、1ーエトキシエチル、アダマンチル等が挙げられる。

【0338】炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは 環状のアルケニル基としては、エテニル、プロペニル、 イソプロペニル、シクロヘキセン等が挙げられる。

【0339】炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは 環状のアルキニル基としては、アセチレン、プロペニレ ン等が挙げられる。

【0340】炭素数1~20の直鎖状、分岐状あるいは 環状のアルコキシ基としては、メトキシ、エトキシ、プ ロピルオキシ、ブトキシ、シクロヘキシルオキシ、イソ ブトキシ、ドデシルオキシ等が挙げられる。

【0341】炭素数6~20の置換もしくは非置換のアリール基としては、フェニル、ナフチル、アントラニル等が挙げられる。

【0342】アリール基の置換基としてはアルキル基、 ニトロ基、水酸基、アルコキシ基、アシル基、アルコキ シカルボニル基、ハロゲン原子を挙げることができる。

【0343】R₃₃₉ における、炭素数1~20の直鎖状、分岐状あるいは環状のアルキレン基(ここで、アルキレン基の鎖中に酸素原子、窒素原子を含んでいてもよい)、としては、メチレン、エチレン、プロピレン、ブチレン、イソブチレン、エトキシエチレン、シクロヘキシレン等が挙げられる。

【0344】炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは 環状のアルケニレン基としては、ビニレン、アリレン等 が挙げられる。

【0345】具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

[0346]

【化128】

40

【化129】

[0347]

191

(
$$\bigcirc$$
) 3+ $-\bigcirc$ - CH₂COO- (\bigcirc) 3+ \bigcirc 2N- \bigcirc - COO-
(\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) 3+ \bigcirc CH₂COO-
(\bigcirc) 3+ \bigcirc CH₂COO-
(\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) (\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) (\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) (\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) (\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) (\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) (\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) (\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) (\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) (\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) (\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) (\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) (\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) (\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) (\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) (\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) (\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) (\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) (\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) (\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) (\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) (\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) (\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) (\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) (\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) (\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) (\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) (\bigcirc) (\bigcirc) 3+ \bigcirc COO-
(\bigcirc) (\bigcirc

$$(\bigcirc)_{3}^{S+} CH_{3}CH_{2}COO- (\bigcirc)_{3}^{S+} \bigcirc -COO- (\square-12)$$

$$(\square-12)$$

$$(\bigcirc)_{3}^{S+} CH_{3}(CH_{2})_{7}COO- (\bigcirc)_{3}^{S+} -\bigcirc -COO- (\bigcirc)_{3}^{S+}$$

[0348]

194

[0349]

【化131】

$$(+0)_3^{S+}$$
 $(11-35)$ $(+0)_3^{S+}$ $(-1-35)$

[0350] [化132]

【0351】上記光酸発生剤、すなわち一般式(A I)、一般式(AII)、一般式(AIII)で表される化 合物は、米国特許第3,734,928号明細書に記載 の方法、Macromo lecules, vol. 10, 1307 (1977), Journ al of Organic Chemistry, vol.55, 4222(1990), J. Ra diat. Curing, vol. 5(1), 2(1978) に記載の方法など を用い、更にカウンターアニオンを交換することにより 合成できる。

【0352】一般式(AIV)、一般式(AV)で表さ れる化合物は、Nーヒドロキシイミド化合物とカルボン 酸クロリドを塩基性条件で反応させる、あるいはニトロ ベンジルアルコールとカルボン酸クロリドを塩基性条件 下反応させることにより得られる。

【0353】〔d〕次に、化合物aと併用することが好 ましい活性放射線の照射によりフッ素含有カルボン酸を 発生する化合物dについて説明する。

【0354】フッ素含有カルボン酸としては、例えば、 フッ素置換された脂肪族カルボン酸及び芳香族族カルボ ン酸を挙げることができる。

【0355】フッ素置換された脂肪族カルボン酸として は、酢酸、プロピオン酸、n-酪酸、イソ酪酸、バレリ アン酸、トリメチル酢酸、カプロン酸、ヘプタン酸、カ プリル酸、ペラルゴン酸、カプリン酸、ラウリル酸、ミ 50 換された脂肪族あるいは芳香族のカルボン酸のアニオン

リスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ウンデカン 酸、ドデカン酸、トリデカン酸等の脂肪族カルボン酸の フッ素置換物が挙げられる。これらは、水酸基、アルコ キシ基、ハロゲン原子を置換基として有していてもよ い。また、その脂肪族鎖の中に酸素原子、硫黄原子、カ ルボニル基、カルボキシル基、スルホニル基などの連結 基を含んでいるものが好ましい。

【0356】好ましいフッ素置換された脂肪族カルボン 酸として、下記の一般式で表されるものを挙げることが 10 できる。

[0357]

L-(CH₂) p (CF₂) q (CH₂) r-COOH一般式中、Lは、水素原子又はフッ素原子を表す。p及 びrは、各々独立に0~15の整数、qは1~15の整 数を表す。この一般式におけるアルキル鎖の水素原子又 はフッ素原子は、フッ素原子で置換されていてもよいア ルキル基(好ましくは炭素数1~5)、フッ素原子で置 換されていてもよいアルコキシ基(好ましくは炭素数1 ~5)、または、水酸基で置換されていてもよい。

【0358】上記フッ素置換された脂肪族カルボン酸と しては、好ましくはその炭素数が2~20、より好まし くは4~20である飽和脂肪族カルボン酸のフッ素置換 物であることが好ましい。この炭素数を4個以上とする ことで、発生するカルボン酸分解性の拡散性が低下し、 露光から後加熱までの経時による線幅変化をより抑制で きる。なかでも、炭素数4~18個の直鎖又は分岐飽和 脂肪族カルボン酸のフッ素置換物が好ましい。

【0359】また、上記フッ素置換された芳香族族カル ボン酸としては、炭素数が7~20、より好ましくは7 ~15であり、更に好ましくは7~11である芳香族カ ルボン酸のフッ素置換物であることが好ましい。具体的 には、安息香酸、置換安息香酸、ナフトエ酸、置換ナフ トエ酸、アントラセンカルボン酸、置換アントラセンカ ルボン酸(ここで、置換基としてはアルキル基、アルコ キシ基、水酸基、ハロゲン原子、アリール基、アシル 基、アシルオキシ基、ニトロ基、アルキルチオ基、アリ ールチオ基が挙げられる)等の芳香族カルボン酸のフッ 素置換物が挙げられる。なかでも、安息香酸、置換安息 香酸のフッ素置換物が好ましい。

【0360】これらフッ素原子で置換された脂肪族ある いは芳香族のカルボン酸は、カルボキシル基以外の骨格 に存在する水素原子の1個以上がフッ素原子で置換され たものであり、特に好ましくはカルボキシル基以外の骨 格に存在する水素原子すべてがフッ素原子で置換された 脂肪族あるいは芳香族のカルボン酸(パーフルオロ飽和 脂肪族カルボン酸あるいはパーフルオロ芳香族カルボン 酸)である。これにより、感度が一層優れるようにな る。

【0361】好ましくは、上記のようなフッ素原子で置

をカウンターアニオンとして有するオニウム塩化合物 (スルホニウム塩、ヨードニウム塩等)、カルボン酸エステル基を有するイミドカルボキシレート化合物あるい はニトロベンジルエステル化合物等が挙げられる。

【0362】より好ましくは下記一般式(I)~(II I)で表される化合物が挙げられる。これにより、感 度、解像力、露光マージンが一層優れるようになる。こ の化合物に活性放射線を照射することより、一般式 (I)~(III)のX⁻に相当する少なくとも1つのフッ 素原子で置換された飽和脂肪族あるいは芳香族のカルボ ン酸を発生し、光酸発生剤として機能する。

[0363]

$$R_{29}$$
 R_{28} R_{37} R_{36} R_{3} R_{3}

$$R_{18}$$
 R_{18}
 R_{20}
 R_{20}
 R_{22}
 R_{24}
 R_{25}
 R_{25}
 R_{25}
 R_{28}
 R_{18}
 R_{19}
 R_{19}
 R_{11}
 R_{21}
 R_{22}
 R_{23}
 R_{27}
 R_{26}
 R_{26}

【0364】(上記式中、R1~R37は、各々独立に、水素原子、直鎖、分岐あるいは環状アルキル基、直鎖、分岐あるいは環状アルコキシ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、またはーSーR38基を表す。ここでR38は直鎖、分岐、環状アルキル基またはアリール基を表す。X30 は、少なくとも1つのフッ素原子で置換された脂肪族あるいは芳香族のカルボン酸のアニオンである。)X-は、好ましくはパーフルオロ脂肪族カルボン酸あるいはパーフルオロ芳香族カルボン酸のアニオンであり、特に好ましくは炭素数4個以上のフッ素置換アルキルカルボン酸のアニオンである。

【0365】一般式(I)~(III)における、R1~R38の直鎖、分岐アルキル基としては、置換基を有してもよい、メチル基、エチル基、プロピル基、nーブチル基、secーブチル基、tーブチル基のような炭素数140~4個のものが挙げられる。環状アルキル基としては、置換基を有してもよい、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基のような炭素数3~8個のものが挙げられる。

【0366】 $R_1 \sim R_{37}$ のアルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、ヒドロキシエトキシ基、プロポキシ基、n-プトキシ基、イソプトキシ基、sec-プトキシ基、t-プトキシ基のような炭素数 $1\sim 4$ 個のものが挙げられる。

【0367】R1~R37のハロゲン原子としては、フッ

素原子、塩素原子、臭素原子、沃素原子を挙げることが できる。

【0368】R38のアリール基としては、フェニル基、トリル基、メトキシフェニル基、ナフチル基等の炭素数6~14個のものが挙げられる。アリール基は置換基を有してもよい。

【0369】これらの置換基として好ましくは、炭素数1~4個のアルコキシ基、ハロゲン原子(フッ素原子、塩素原子、沃素原子)、炭素数6~10個のアリール基、炭素数2~6個のアルケニル基、シアノ基、ヒドロキシ基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、ニトロ基等が挙げられる。

【0370】本発明で使用される一般式(I)~(II I)で表されるヨードニウム化合物あるいはスルホニウム化合物は、その対アニオンX・として、少なくとも1つのフッ素原子で置換された飽和脂肪族あるいは芳香族のカルボン酸のアニオンを有する。これらのアニオンは、該カルボン酸(-COOH)の水素原子が離脱したアニオン(-COO・)である。

【0371】以下に、具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0372】一般式(I)で表される光酸発生剤の具体例(I-1f)~(I~36f):

[0373]

50 【化134】

(1-11f)

201

(CF3COO	(I-1f)

$$(1-3f)$$

$$(I-4f)$$

$$(1-6f)$$

[0374] [化135]

$$\left(\begin{array}{c} \\ \\ \end{array}\right)_{2}$$
 1^{+} $CF_{2}HCOO^{-}$

202

$$\left(\begin{array}{cccc} & & & \\ & & \\ & & \\ \end{array}\right)_{2}^{+} \quad CF_{3}(CF_{2})_{2}COO^{-} \quad (1-16f)$$

$$(CF_3(CF_2)_3COO^{-1})$$

$$(\bigcirc)_{2}^{+} \downarrow^{+} \qquad F - \bigcirc F - \bigcirc COO^{-} \quad (1-18f)$$

30 [0375] 【化136】

NHCO(CH₂)₅CH₃

(1-23f) CF₃(CF₂)₃COO

NHCO(CH₂)₈CH₃ CF₃(CF₂)₇COO

(1-24f)

[0376] 【化137】

)

1+ CF₃(CF₂)₁₀COO-(I-25f)

$$(I-26f)$$

(CF₃(CF₂)₁₀COO-(I-27f)

$$\left(\begin{array}{c} \downarrow \\ \downarrow \\ 2 \end{array}\right)$$
 |+ CF₃(CF₂)₁₂COO-
(I-28f)

$$(I-29f)$$

$$(CF_3(CF_2)_{12}COC$$

$$(I-30f)$$

$$(- + CF_3(CF_2)_9COO- (I-32f)$$

[0379]

【化139】

$$(\Box)_{3}^{+} s^{+} \qquad CF_{3}COO^{-} \qquad (II-1f)$$

$$(\bigcirc)_{3}^{+} s^{+} \qquad CF_{3}CF_{2}COO^{-} \qquad (II-2f)$$

$$(\bigcirc)_{3}^{+} s^{+} \qquad CF_{3}(CF_{2})_{2}COO^{-} \qquad (II-3f)$$

$$(\bigcirc)_{3}^{+} s^{+} \qquad CF_{3}(CF_{2})_{3}COO^{-} \qquad (II-4f)$$

$$(\bigcirc)_{3}^{+} s^{+} \qquad CF_{3}(CF_{2})_{7}COO^{-} \qquad (II-6f)$$

$$(\bigcirc)_{3}^{+} s^{+} \qquad F-\bigcirc -COO^{-} \qquad (II-6f)$$

$$(\bigcirc)_{3}^{+} s^{+} \qquad F-\bigcirc -COO^{-} \qquad (II-7f)$$

$$(\bigcirc)_{3}^{+} s^{+} \qquad F-\bigcirc -COO^{-} \qquad (II-8f)$$

$$(\bigcirc)_{3}^{+} s^{+} \qquad F-\bigcirc -COO^{-} \qquad (II-8f)$$

[0380] 【化140】

207

(O)—s⁺ (II-10f) [0381]

 $\begin{array}{cccc} & & & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & &$

(S) S^+ CF_2CICOO^- (11-12f)

 $\left(\bigcirc \right)_{3}^{+} S^{+} F \longrightarrow F \longrightarrow F \longrightarrow F$ $\left(\bigcirc \right)_{3}^{+} \left(\bigcirc \right)_{3}^{+} \left($

 $(\bigcirc) + S^{+} CF_{3}CH(OH)COO (11-15f)$

 $(CF_3)_2C(OH)COO^{-20}$

 $(\bigcirc) + S^{+} \qquad HO - \bigcirc -COO^{-} \qquad (II-17f)$

 $CF_3(CF_2)_{16}COO^{-}$ (11-18f)

30

210

[0382]

30 【化142】

212

[0383]

【化143】

40

30

[0384]

214

$$CF_{2}CICOO^{-} \qquad (II-29f)$$

$$CM_{0} \longrightarrow S^{+} \qquad CF_{3}(CF_{2})_{3}COO^{-} \qquad (II-30f)$$

$$CF_{3}(CF_{2})_{2}COO^{-} \qquad (II-31f)$$

$$CF_{3}(CF_{2})_{2}COO^{-} \qquad (II-32f)$$

$$F \longrightarrow F \qquad COO^{-} \qquad (II-32f)$$

$$F \longrightarrow F \qquad CF_{3}COO^{-} \qquad (II-34f)$$

$$F \longrightarrow G_{3}(CF_{2})_{2}COO^{-} \qquad (II-35f)$$

$$G_{1}(F_{2})_{2}COO^{-} \qquad (II-35f)$$

$$G_{1}(F_{2})_{2}COO^{-} \qquad (II-35f)$$

40

216

$$(+ \bigcirc)_{3}^{+} S^{+} CF_{3}(CF_{2})_{3}COO^{-} (11-38f)$$

$$(+ \bigcirc)_{3}^{+} S^{+} CF_{3}(CF_{2})_{7}COO^{-} (11-37f)$$

$$(+ \bigcirc)_{3}^{+} S^{+} F^{-} COO^{-} (11-38f)$$

$$(+ \bigcirc)_{3}^{+} S^{+} F^{-} COO^{-} (11-39f)$$

$$(+ \bigcirc)_{3}^{+} S^{+} F^{-} COO^{-} (11-40f)$$

[0385]

Αñ

[0386]

218

$$CF_{2}CICOO^{-} \qquad (11-44f)$$

$$CF_{3}(CF_{2})_{3}COO^{-} \qquad (11-48f)$$

$$CF_{3}(CF_{2})_{7}COO^{-} \qquad (11-48f)$$

$$CF_{3}(CF_{2})_{7}COO^{-} \qquad (11-48f)$$

$$CF_{3}(CF_{2})_{2}COO^{-} \qquad (11-48f)$$

40

【化146】

220

$$(\bigcirc)_{3}^{3+} \quad CF_{3}(CF_{2})_{10}COO .$$

$$(II-49f) \qquad (II-50f)$$

$$(II-52f) \qquad (II-52f)$$

$$(II-52f) \qquad (II-52f)$$

$$(II-52f) \qquad (II-52f)$$

$$(II-53f) \qquad (II-54f)$$

$$(II-54f) \qquad (II-54f)$$

$$(II-54f) \qquad (II-56f)$$

$$(II-55f) \qquad (II-56f)$$

$$(II-56f) \qquad (II-56f)$$

$$(II-57f) \qquad (II-58f)$$

$$(II-58f) \qquad (II-58f)$$

[0387] [化147]

30

20

[0389]

【化148】

222

【0388】一般式(III)で表される光酸発生剤の具

体例 (III-1f)~(III~4f):

(II-61f)

(CF3(CF3)0COO-(II-62f)

(II-65f)

(II-67f)

$$S \xrightarrow{} S \qquad 2 \text{ CF}_3\text{COO} \qquad \text{(III-1f)}$$

$$S \xrightarrow{F} S = F \xrightarrow{F} COO^{-} (III-3f)$$

【0390】その他の光酸発生剤の具体例(IV-1f) $\sim (V \sim 4 f)$:

[0391]

$$O CF_3$$
 (V-1f)

【0392】上記一般式(I)で表される化合物は、過 ヨウ素酸塩を用いて芳香族化合物を反応させ、得られた ヨードニウム塩を対応するカルボン酸に塩交換すること により合成可能である。

【0393】一般式(II)、一般式(III)で表される 化合物は、例えば、アリールマグネシウムプロミドなど 40 のアリールグリニャール試薬と置換又は無置換のフェニ ルスルホキシドを反応させ、得られたトリアリールスル ホニウムハライドを対応するカルボン酸と塩交換する方 法で合成できる。また、置換又は無置換のフェニルスル ホキシドと対応する芳香族化合物をメタンスルホン酸/ 五酸化二リンあるいは塩化アルミニウムなどの酸触媒を 用いて縮合、塩交換する方法、ジアリールヨードニウム

塩とジアリールスルフィドを酢酸銅などの触媒を用いて 縮合、塩交換する方法などによって合成できる。

【0394】塩交換は、いったんハライド塩に導いた後 に酸化銀などの銀試薬を用いてカルボン酸塩に変換する 方法、あるいはイオン交換樹脂を用いることでも塩交換 できる。また、塩交換に用いるカルボン酸あるいはカル ボン酸塩は、市販のものを用いるか、あるいは市販のカ ルボン酸ハライドの加水分解などによって得ることがで きる。

【0395】アニオン部分としてのフッ素置換されたカ ルポン酸は、テロメリゼーション法(テロマー法ともい われる)もしくはオリゴメリゼーション法(オリゴマー 法ともいわれる)により製造されたフルオロ脂肪族化合 物から導かれるものを用いたものも好ましい。これらの フルオロ脂肪族化合物の製造法に関しては、例えば、

「フッ素化合物の合成と機能」(監修:石川延男、発 行:株式会社シーエムシー、1987)の117~11 8ページや、「Chemistry of Organic Fluorine Compo unds IIJ (Monograph 187, Ed by Milos Hudlicky and Attila E. Pavlath, American Chemical Society 199 5) の747-752ページに記載されている。テロメ リゼーション法とは、沃化物等の連鎖移動常数の大きい アルキルハライドをテローゲンとして、テトラフルオロ エチレン等のフッ素含有ビニル化合物のラジカル重合を 行い、テロマーを合成する方法である(Scheme-1に例を 示した)。テロマー法による合成においては炭素鎖長の 異なる複数の化合物の混合物が得られるが、これを混合 物のまま使用してもよいし、精製して用いてもよい。

【0396】化合物 a と化合物 b ~ d の総量の重量比 は、通常1/1~50/1、好ましくは1/1~10/ 1、特に好ましくは2/1~5/1である。

【0397】化合物aと化合物b~dの合計量は、組成 物全固形分に対し、通常0.5~20重量%、好ましく は0.75~15重量%、より好ましくは1~10重量 %の範囲である。化合物 a と化合物 b ~ d は、各々複数 種含有してもよい。

【0398】本発明の組成物には、有機塩基性化合物を 用いることができる。これにより、保存時の安定性が更 に向上し、かつPEDによる線巾変化が更に少なくなる ため好ましい。

【0399】本発明で用いることのできる好ましい有機 塩基性化合物とは、フェノールよりも塩基性の強い化合 物である。中でも含窒素塩基性化合物が好ましい。

【0400】好ましい化学的環境として、下記式(A) ~(E)構造を挙げることができる。

[0401]

【化150】

$$R^{251}$$
 $R^{250} - N - R^{252}$... (A)

ここで、 R^{250} 、 R^{251} および R^{252} は、同一または異なり、水素原子、炭素数 $1 \sim 6$ のアルキル基、炭素数 $1 \sim 6$ のアミノアルキル基、炭素数 $1 \sim 6$ のとドロキシアルキル基または炭素数 $6 \sim 2$ 0の置換もしくは非置換のアリール基であり、ここで R^{251} と R^{252} は互いに結合して環を形成してもよい。

$$-N-C=N- \qquad \cdots (B)$$

$$=C-N=C- \qquad \cdots (C)$$

$$=C-N- \qquad \cdots (D)$$

$$R^{254}-R^{255}-R^{256}- \cdots (E)$$

(式中、R^{253、R^{254、R²⁵⁵}およびR²⁵⁶は、同一または異なり、炭素数 1 ~ 6のアルキル基を示す)}

【0402】更に好ましい化合物は、窒素含有環状化合物(環状アミン化合物ともいう)あるいは一分子中に異なる化学的環境の窒素原子を2個以上有する含窒素塩基性化合物である。

【0403】環状アミン化合物としては、多環構造であることがより好ましい。環状アミン化合物の好ましい具体例としては、下記一般式(F)で表される化合物が挙 30 げられる。

[0404]

【化151】

【0409】上記の中でも、1、8-ジアザビシクロ 〔5.4.0〕ウンデカー7-エン、1、5-ジアザビシクロ〔4.3.0〕ノナー5-エンが特に好ましい。 【0410】一分子中に異なる化学的環境の窒素原子を 2個以上有する含窒素塩基性化合物としては、特に好ま しくは、置換もしくは未置換のアミノ基と窒素原子を含 50

【0405】式(F)中、Y、Zは、各々独立に、ヘテロ原子を含んでいてもよく、置換してもよい直鎖、分岐、環状アルキレン基を表す。

226

【0406】ここで、ヘテロ原子としては、窒素原子、硫黄原子、酸素原子が挙げられる。アルキレン基としては、炭素数2~10個が好ましく、より好ましくは2~5個のものである。アルキレン基の置換基としては、炭素数1~6個のアルキル基、アリール基、アルケニル基の他、ハロゲン原子、ハロゲン置換アルキル基が挙げられる。

【0407】更に、一般式(F)で示される化合物の具体例としては、下記に示す化合物が挙げられる。

[0408]

む環構造の両方を含む化合物もしくはアルキルアミノ基を有する化合物である。好ましい具体例としては、置換もしくは未置換のグアニジン、置換もしくは未置換のアミノアルキルピミノピリジン、置換もしくは未置換のアミノピロリジン、置換もしくは未置換のインダーゾル、置換もしくは未置換の

ピラゾール、置換もしくは未置換のピラジン、置換もしくは未置換のピリミジン、置換もしくは未置換のプリン、置換もしくは未置換のピペラジン、置換もしくは未置換のアミノモルフォリン、置換もしくは未置換のアミノアルキルフォリン等が挙げられる。好ましい置換基は、アミノ基、アミノアルキル基、アルキルアミノ基、アミノアリール基、アリールアミノ基、アルキル基、アルコキシ基、アシル基、アシロキシ基、アリール基、アリールオキシ基、ニトロ基、水 10酸基、シアノ基である。

【0411】特に好ましい化合物として、グアニジン、 1,1ージメチルグアニジン、1,1、3,3ーテトラメ チルグアニジン、2ーアミノピリジン、3ーアミノピリ ジン、4ーアミノピリジン、2ージメチルアミノピリジ ン、4ージメチルアミノピリジン、2ージエチルアミノ ピリジン、2ー(アミノメチル)ピリジン、2ーアミノ ー3ーメチルピリジン、2ーアミノー4ーメチルピリジ ン、2-アミノー5-メチルピリジン、2-アミノー6 ーメチルピリジン、3-アミノエチルピリジン、4-ア 20 ミノエチルピリジン、3ーアミノピロリジン、ピペラジ ン、N-(2-アミノエチル)ピペラジン、N-(2-アミノエチル) ピペリジン、4ーアミノー2,2,6,6 ーテトラメチルピペリジン、4-ピペリジノピペリジ ン、2ーイミノピペリジン、1ー(2ーアミノエチル) ピロリジン、ピラゾール、3-アミノー5-メチルピラ ゾール、5ーアミノー3ーメチルー1ーpートリルピラ ゾール、ピラジン、2-(アミノメチル)-5-メチル ピラジン、ピリミジン、2.4ージアミノピリミジン、 4,6ージヒドロキシピリミジン、2ーピラゾリン、3 ーピラゾリン、Nーアミノモルフォリン、Nー(2ーア ミノエチル)モルフォリン、トリメチルイミダゾール、 トリフェニルイミダゾール、メチルジフェニルイミダゾ ール等が挙げられるがこれに限定されるものではない。 【0412】これらの含窒素塩基性化合物は、単独であ るいは2種以上一緒に用いられる。含窒素塩基性化合物 の使用量は、ポジ型レジスト組成物(溶媒を除く)10 0重量部に対し、通常、0.001~10重量部、好ま しくは0.01~5重量部である。

【0413】0.001重量部未満では上記効果が得ら 40 れない。一方、10重量部を超えると感度の低下や非露 光部の現像性が悪化する傾向がある。

【0414】本発明の化学増幅型ポジレジスト組成物には必要に応じて、更に界面活性剤、染料、顔料、可塑剤、光増感剤及び現像液に対する溶解性を促進させるフェノール性OH基を2個以上有する化合物等を含有させることができる。

【0415】本発明のポジ型レジスト組成物には、界面 活性剤を含有することが好ましい。具体的には、ポリオ キシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンス 50

テアリルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエーテ ル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル等のポリオキ シエチレンアルキルエーテル類、ポリオキシエチレンオ クチルフェノールエーテル、ポリオキシエチレンノニル フェノールエーテル等のポリオキシエチレンアルキルア リルエーテル類、ポリオキシエチレン・ポリオキシプロ ピレンブロックコポリマー類、ソルビタンモノラウレー ト、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタンモノステ アレート、ソルビタンモノオレエート、ソルビタントリ オレエート、ソルビタントリステアレート等のソルビタ ン脂肪酸エステル類、ポリオキシエチレンソルビタンモ ノラウレート、ポリオキシエチレンソルビタンモノパル ミテート、ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレ ート、ポリオキシエチレンソルビタントリオレエート、 ポリオキシエチレンソルビタントリステアレート等のポ リオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類等のノニ オン系界面活性剤、エフトップEF301、EF30 3、EF352 (新秋田化成(株)製)、メガファック F171、F173、F176、F189、R08 (大 日本インキ(株)製)、フロラードFC430、FC4 31 (住友スリーエム(株)製)、アサヒガードAG7 10、サーフロンS-382、SC101、SC10 2, SC103, SC104, SC105, SC106 (旭硝子(株)製)等のフッ素系界面活性剤、オルガノ シロキサンポリマーKP341(信越化学工業(株) 製)やアクリル酸系もしくはメタクリル酸系(共)重合 ポリフローNo. 75、No. 95 (共栄社油脂化学工 業(株)製)、トロイゾルS-366(トロイケミカル (株) 製) 等を挙げることができる。

【0416】これらの界面活性剤の中でも、フッ素系またはシリコン系界面活性剤が塗布性、現像欠陥低減の点で好ましい。

【0417】界面活性剤の配合量は、本発明の組成物中の全組成物の固形分に対し、通常0.01重量%~2重量%、好ましくは0.01重量%~1重量%である。

【0418】これらの界面活性剤は1種単独であるいは 2種以上を組み合わせて用いることができる。

【0419】本発明の樹脂においては、特開平9-319092号など従来アセタール基を含有する樹脂に比較して、不純物として含まれる酸(これは主として酸発生剤中の不純物、あるいは本発明の樹脂合成時に使用の触媒から由来する)の含有量の影響が認められた。

【0420】即ち、本発明のレジスト組成物中に不純物として含まれる酸の含有量が500ppmよりも多い場合、本発明の効果である優れたパターンプロファイル形状および真空チャンバー中での引き置き時間での少ない線幅変動が損なわれる。

【0421】従って、本発明のレジスト組成物においては、レジスト組成物中に不純物として含まれる酸の含有 畳を500ppm以下に抑えることが必要であり、好ま

しくは200ppm以下、さらに好ましくは100ppm以下である。

【0422】さらに、下記に挙げるような分光増感剤を添加し、使用する酸発生剤が吸収を持たない遠紫外より 長波長領域に増感させることで、本発明の化学増幅型ポ ジレジストを I 又は g 線に感度を持たせることができ る。

【0423】好適な分光増感剤としては、具体的にはべ ンゾフェノン、p,p'ーテトラメチルジアミノベンゾ フェノン、p,p'ーテトラエチルエチルアミノベンゾ フェノン、2ークロロチオキサントン、アントロン、9 ーエトキシアントラセン、アントラセン、ピレン、ペリ レン、フェノチアジン、ベンジル、アクリジンオレン ジ、ベンゾフラビン、セトフラビンーT、9.10ージ フェニルアントラセン、9ーフルオレノン、アセトフェ ノン、フェナントレン、2ーニトロフルオレン、5ーニ トロアセナフテン、ベンゾキノン、2-クロロー4-ニ トロアニリン、Nーアセチルーpーニトロアニリン、p ーニトロアニリン、Nーアセチルー4ーニトロー1ーナ フチルアミン、ピクラミド、アントラキノン、2-エチ 20 ルアントラキノン、2-tert-ブチルアントラキノン、 1,2-ベンズアンスラキノン、3-メチルー1,3-ジ アザー1.9ーベンズアンスロン、ジベンザルアセト ン、1,2ーナフトキノン、3,3'ーカルボニルービス (5,7ージメトキシカルボニルクマリン)及びコロネ ン等であるがこれらに限定されるものではない。

【0424】現像液に対する溶解性を促進させるフェノール性OH基を 2 個以上有する化合物としては、ポリヒドロキシ化合物が挙げられ、好ましくはポリヒドロキシ化合物には、フェノール類、レゾルシン、フロログルシ 30ン、フロログルシド、2,3,4-トリヒドロキシベンゾフェノン、2,3,4,4'ーテトラヒドロキシベンゾフェノン、 α,α α ートリス(4-ヒドロキシフェニル)-1,3,5-トリイソプロピルベンゼン、トリス(4-ヒドロキシフェニル)メタン、トリス(4-ヒドロキシフェニル)エタン、1,1'ービス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサンがある。

【0425】本発明の化学増幅型ポジ型レジスト組成物は、上記各成分を溶解する溶媒に溶かして支持体上に塗布するものであり、使用することのできる溶媒としては、エチレンジクロライド、シクロペキサノン、シクロペンタノン、2ーペプタノン、γーブチロラクトン、メチルエチルケトン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、トルエン、酢酸エチル、乳酸メチル、乳酸エチル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸メチル、ピルピン酸エチル、ピルピン酸メチル、ピルピン酸エチル、

ピルビン酸プロピル、N、Nージメチルホルムアミド、 ジメチルスルホキシド、Nーメチルピロリドン、テトラ ヒドロフラン等が好ましく、これらの溶媒を単独あるい は混合して使用する。

【0426】上記化学増幅型ポジ型レジスト組成物は精密集積回路素子の製造に使用されるような基板(例:シリコン/二酸化シリコン被覆)上にスピナー、コーター等の適当な塗布方法により塗布後、所定のマスクを通して露光し、ベークを行い現像することにより良好なレジストパターンを得ることができる。

【0427】本発明の化学増幅型ポジ型レジスト組成物 の現像液としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化 カリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、リン酸 ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア水等の 無機アルカリ類、エチルアミン、nープロピルアミン等 の第1アミン類、ジエチルアミン、ジーnーブチルアミ ン等の第2アミン類、トリエチルアミン、メチルジエチ ルアミン等の第3アミン類、ジメチルエタノールアミ ン、トリエタノールアミン等のアルコールアミン類、ホ ルムアミドやアセトアミド等のアミド類、テトラメチル アンモニウムヒドロキシド、トリメチル(2-ヒドロキ シエチル)アンモニウムヒドロキシド、テトラエチルア ンモニウムヒドロキシド、トリブチルメチルアンモニウ ムヒドロキシド、テトラエタノールアンモニウムヒドロ キシド、メチルトリエタノールアンモニウムヒドロキシ ド、ベンジルメチルジエタノールアンモニウムヒドロキ シド、ベンジルジメチルエタノールアンモニウムヒドロ キシド、ベンジルトリエタノールアンモニウムヒドロキ シド、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド、テト ラブチルアンモニウムヒドロキシド等の第4級アンモニ ウム塩、ピロール、ピペリジン等の環状アミン等のアル カリ類の水溶液等がある。

[0428]

【実施例】以下、本発明によって更に具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0429】〔合成例 I - 1 ビニルエーテルの合成〕 p - シクロヘキシルフェノール83.1g(0.5 モル)を300mlのトルエンに溶解し、次いで2 - クロロエチルビニルエーテル150gを加え、さらに水酸化ナトリウム25g、テトラブチルアンモニウムブロミド5g、トリエチルアミン60gを加えて、120℃にて5時間加熱攪拌した。反応液を水洗し、減圧留去にて過剰のクロロレチルビニルエーテルとトルエンを除去した。得られたオイル分から、減圧蒸留により、目的物であるp - シクロヘキシルフェノキシエチルビニルエーテル(X-1)を得た。

【0430】〔合成例 I-2、3、4、5、6、7、8、9〕合成例 I-1と同様にして、以下に示すビニルエーテルX-2, X-3, X-4, X-5, X-6, X -7, X-8, X-9をそれぞれ得た。

$$= -0 - 0$$
 X-1

[0432]

【0433】〔合成例II-1〕p-アセトキシスチレン32.4g(0.2モル)を酢酸ブチル120mlに溶解し、窒素気流および投拌下、80℃にてアゾビスイソブチロニトリル(AIBN)0.033gを2.5時間置きに3回添加し、最後に更に5時間攪拌を続けることにより、重合反応を行った。反応液をヘキサン1200mlに投入し、白色の樹脂を析出させた。得られた樹脂を乾燥後、メタノール150mlに溶解した。これに水酸化ナトリウム7.7g(0.19モル)/水50mlの水溶液を添加し、3時間加熱還流することにより加水分解させた。その後、水200mlを加えて希釈し、塩酸にて中和し白色の樹脂を析出させた。この樹脂を識別し、水洗・乾燥させた。更にテトラヒドロフラン200mlに溶解し、5Lの超純水中に激しく攪拌しながら商

下、再沈を行った。この再沈操作を3回繰り返した。得られた樹脂を真空乾燥器中で120℃、12時間乾燥し、ポリ(pーヒドロキシスチレン)アルカリ可溶性樹脂R-1を得た。得られた樹脂の重量平均分子量は15000であった。

【0434】〔合成例II-2〕常法に基づいて脱水、蒸 留精製したp-tertーブトキシスチレンモノマー3 5. 25g(0. 2モル) およびスチレンモノマー5. 21g(0.05モル)をテトラヒドロフラン100m 1に溶解した。窒素気流および拠拌下、80℃にてアゾ ビスイソプチロニトリル (AIBN) O. 033gを 2. 5時間置きに3回添加し、最後に更に5時間攪拌を 続けることにより、重合反応を行った。反応液をヘキサ ン1200mlに投入し、白色の樹脂を析出させた。得 られた樹脂を乾燥後、テトラヒドロフラン150mlに 溶解した。これに4N塩酸を添加し、6時間加熱還流す ることにより加水分解させた後、5Lの超純水に再沈 し、この樹脂を濾別し、水洗・乾燥させた。更にテトラ ヒドロフラン200mlに溶解し、5Lの超純水中に激 しく攪拌しながら滴下、再沈を行った。この再沈操作を 3回繰り返した。得られた樹脂を真空乾燥器中で120 ℃、12時間乾燥し、ポリ(p-ヒドロキシスチレン/ スチレン) 共重合体アルカリ可溶性樹脂 R-2を得た。 得られた樹脂の重量平均分子量は12000であった。 【0435】〔合成例II-3〕pーアセトキシスチレン 32.4g(0.2モル)およびメタクリル酸メチル 7.01g(0.07モル)を酢酸プチル120mlに 溶解し、窒素気流および攪拌下、80℃にてアゾビスイ ソプチロニトリル (AIBN) 0. 033gを2. 5時 間置きに3回添加し、最後に更に5時間攪拌を続けるこ とにより、重合反応を行った。反応液をヘキサン120 0mlに投入し、白色の樹脂を析出させた。得られた樹 脂を乾燥後、メタノール200mlに溶解した。これに 水酸化ナトリウム7.7g(0.19モル)/水50m 1の水溶液を添加し、1時間加熱還流することにより加 水分解させた。その後、水200mlを加えて希釈し、 塩酸にて中和し白色の樹脂を析出させた。この樹脂を濾 別し、水洗・乾燥させた。更にテトラヒドロフラン20 0m1に溶解し、5Lの超純水中に激しく攪拌しながら 滴下、再沈を行った。この再沈操作を3回繰り返した。 得られた樹脂を真空乾燥器中で120℃、12時間乾燥 し、ポリ(p-ヒドロキシスチレン/メタクリル酸メチ ル)共重合体アルカリ可溶性樹脂R-3を得た。得られ た樹脂の重置平均分子量は10000であった。

【0436】〔合成例II-4〕日本曹達株式会社製、ポリ(p-ヒドロキシスチレン) (VP8000)をアルカリ可溶性樹脂R-4とした。重量平均分子量は9800であった。

【0437】〔合成例III-1〕

合成例II-4で得られたアルカリ可溶性樹脂R-4 2

0 g

テトラヒドロフラン 80ml

合成例 I - 1 で得られたビニルエーテル X - 1 6.5 0 g

をフラスコ中で混合し、pートルエンスルホン酸10mgを添加して、室温下18時間拠拌した。ピリジン50mgを添加した後に、反応液を、超純水5L中に激しく攪拌しながら滴下、再沈を行った。得られた樹脂を真空

乾燥器中で70℃下、12時間乾燥し、本発明に係わる 置換基を有するアルカリ可溶性樹脂B-1を得た。

【0438】 [合成例III-2~III-10] 下記表1に示したアルカリ可溶性樹脂とビニルエーテルを用い、合成例III-1と同様にして本発明に係わる置換基を有するアルカリ可溶性樹脂B-2~B-15を得た。

[0439]

【表1】

3X 1			
樹脂	使用したビニルエーテル	幹ポリマー	組成比 (モル比)
B-1	X-1	R-4	13/87
B-2	X-2	R-4	12/88
B-3	X-3	R-4	14/86
B-4	X-4	R-4	13/87
B-5	X-5	R-4	13/87
B-6	X - 6	R-4	15/85
B-7	X-1	R-1	17/83
B-8	X-2	R-1	15/85
B-9	X – 3	R-1	15/85
B-10	X-4	R – 1	15/85
B-11	X – 5	R-1	14/86
B-12	X – 6	R-1	17/83
B-13	X-7	R-4	12/88
B-14	X-8	R-4	16/84
B-15	X – 9	R-4	15/85

【0440】〔合成例IV-1~IV-4〕下記表2に示したアルカリ可溶性樹脂と、下記式で示されるエチルビニルエーテル(Y-1)、ナフチルオキシエチルビニルエーテル(Y-2)、(ベンジルオキシエトキシ)エチルビニルエーテル(Y-3)を用い、樹脂C-1~C-3を得た。

【0442】 【表2】

[0441]

【化155】

Y-1

Y-3

30

表 2

樹脂	使用したビニルエーテル	幹ポリマー
C - 1	Y-1	R-4
C-2	Y – 2	R-4
C-3	Y – 3	R-4
C-4	Y - 2	R - 1

【0443】 [合成例V-1] <トリフェニルスルホニウムノナフロロブタンスルホネート(VII-4)の合成>トリフェニルスルホニウムヨージド20gをメタノール500mlに溶解させ、これに酸化銀12.5gを加えて室温で4時間損拌した。反応液を濾過して銀化合物を除いた後、この溶液にノナフロロブタンスルホニック 50

アシッド 1 4. 9 gを加え、この溶液を濃縮した。得られた油状物にジイソプロピルエーテル 3 0 0 m l を加えて十分に攪拌した後、ジイソプロピルエーテルをデカントで除く操作を 2 回繰り返した。得られた油状物を減圧乾燥すると目的物が 1 8 g得られた。

【0444】〔合成例V-2〕<トリフェニルスルホニ

ウム 4ードデシルベンゼンスルホネート(PAG4ー1)の合成>トリフェニルスルホニウムヨージド10gをメタノール500mlに溶解させ、これに酸化銀4.4gを加えて室温で4時間攪拌した。反応液を濾過して銀化合物を除いた後、この溶液に4ードデシルベンゼンスルホニックアシッド4.67gを加え、この溶液を濃縮した。得られた油状物にジイソプロピルエーテル300mlを加えて十分に攪拌した後、ジイソプロピルエーテルをデカントで除く操作を2回繰り返した。得られた油状物を減圧乾燥すると目的物が6g得られた。

【0445】 (合成例V-3) <トリフェニルスルホニウムノナフロロペンタノエート(II-4f)の合成>トリフェニルスルホニウムヨージド20gをメタノール500mlに溶解させ、ごれに酸化銀12.5gを加えて室温で4時間撹拌した。反応液をろ過して銀化合物を除いた後、この溶液にノナフロロペンタノイックアシッド14.9gを加え、この溶液を濃縮した。得られた油状物にジイソプロピルエーテル300mlを加えて十分に撹拌した後、ジイソプロピビルエーテルをデカントで除

く操作を2回繰り返した。得られた油状物を減圧乾燥すると目的物が18g得られた。

【0446】界面活性剤 (F-1) として、メガファックR08 (大日本インキ (株) 製) を使用した。

【0447】界面活性剤(F-2)として、トロイゾル S-366(トロイケミカル(株)製)を使用した。

【0448】(実施例1~12、比較例1~6)

「レジスト組成物の調製と評価」下記表 3に示す各素材を PGMEA(プロピレングリコールモノメチルエーテ 10 ルアセテート) 8 g に溶解し、 0 . 2 μ mのフィルターで濾過してレジスト溶液を作成した。なお、界面活性剤の使用量は 0 . 0 0 3 5 g であった。

【0449】このレジスト溶液を、スピンコーターを利用して、シリコンウエハー上に塗布し、130 ℃、60 秒間真空吸着型のホットプレートで乾燥して、膜厚 0.3μ mのレジスト膜を得た。

[0450]

【表3】

表3								
	横窟	樹頭の量金	光酸 発生剂 (重量比)	光酸発生 剤の量 (g)	有機 塩基	有機塩基の量	界面活性剂	界面 活性剤 の量(g)
実施例1	B-1	1,95	D-1	0.17	E-2	0.002	F-1	0.0035
突施例2	B-2	1,95	D-1	0.17	E-2	0.002	F-1	0.0035
実施例3	B-3	1,95	D-1/D-4 (6/4)	0.17	E-2	0.002	F-2	0.0035
実施例4	B-4	1.95	D-1/D-5 (6/4)	0,17	E-2	0.002	F-2	0.0035
实施例5	B-5	1.95	D-1	0.17	E-3	0.002	F-1	0.0035
突旋例6	B-6	1.95	D-1/D-6 (6/4)	0.17	E-2	0.002	F-1	0.0035
突施例7	B-7	1.95	D-1	0.17	E-2	0.002	F-2	0.0035
实施例8	B-8	1.95	D-1	0.17	E-2	0,002	F-1	0.0035
実施例9	B-8	1.95	D-1	0.17	E-3	0.002	F-1	0,0035
実施例 10	B-10	1.95	D-1/D-6 (6/4)	0.17	E-2	0.002	F-2	0.0035
突施例 11	B-11	1.95	D-2	0.17	E-1	0,002	F-1	0.0035
突施例 12	B-12	1,95	D-1/D-4 (8/4)	0.17	E-2	0.002	F-1	0.0035
比較例1	C-1	1.95	D-1	0,17	E-2	0.002	F-2	0.0035
比較例2	C-2	1.95	D-2	0.17	E-1	0.002	F-1	0.0035
比較例3	C-3	1.95	D-2	0.17	E-2	0.002	F-1	0.0035
比較例4	C-4	1,95	D-2	0.17	E-3	0.002	F-2	0.0035
比較例5	B-1	1.95	D-1*	0.17	E-2	0.002	F-1	0.0035
比較例6	C-1	1,95	D-1*	0.17	E-2	0.002	F-1	0.0035

D-1*:不純物として、2,4,6-ドバソフ°CL°M、大°次Mが酸を 970ppm含む *印のない D-1 は上記酸含有量が 500ppm 以下である。

【0451】また、実施例に用いた各光酸発生剤および 有機塩基化合物を以下に示す。

[0452]

【化156】

$$\left(\begin{array}{ccc} \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet \end{array}\right)_3 S^{\bigoplus} C_4 H_9 SO_3 \qquad (D-2)$$

$$CH_3$$
 $C-C$ $-SO_2SO_2$ CH_3 $CH_$

$$(\bigcirc) \xrightarrow{3} S^{\bigoplus} C_4 H_9 CO_2 \qquad (D-4)$$

$$(\bigcirc) -)_3 S^{\oplus} \bigcirc - CO_2^{\bigcirc}$$
 (D-5)

$$(\bigcirc) \rightarrow 3$$
 CH₃CO₂ (D-6)

$$CH_3$$
 $C+ON$
 $(E-1)$
 N
 $(E-2)$

【0453】このレジスト膜に、電子線照射装置(加速電圧50KeV)を用いて照射を行った。照射後100

℃ホットプレートで60秒間加熱を行い、直ちに0.26Nテトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド(TMAH)水溶液で60秒間浸漬し、30秒間水でリンスして乾燥した。このようにして得られたシリコンウェハー上のパターンを走査型電子顕微鏡で観察し、レジストの性能を評価した。

238

【0454】その結果を表4に示す。

【0455】解像力は 0.15μ mのラインアンドスペースのマスクパターンを再現する露光量における限界解 像力を表す。

【0456】得られたレジストパターンを光学顕微鏡あるいはSEMで観察し、レジストパターンの逆テーパーの度合いを観察した。パターンの逆テーパーの傾きの度合いが、非常に少ないもの(殆ど矩形プロファイル)を◎、少ないものを○、パターンの逆テーパーが明らかに観察されるものを×とした。

【0457】また、上記のように得られたレジスト膜を電子線照射装置内で高真空下240分間放置したのち、上記と同様に、露光、現像しレジストパターンを形成した。上記のように高真空下240分間放置して得られたパターンの限界解像線幅(A)と、高真空下で放置しないで得られたパターンの限界解像線幅(B)とを測定し、その変動率を下記のように計算した。その値は小さいほうがよい。

[0458]

変動率= {1-| (B)-(A)|/(B)}×100 【0459】

【表4】

	解像力	レジストパターン	線幅変動率
	(µm)	形状	(%)
実施例1	0. 13	0	<2
実施例2	0. 12	0	<2
実施例3	0. 13	Ø	<2
実施例4	0. 13	· ©	<2
実施例5	0. 13	0	<2
実施例6	0, 13	Ø	<2
実施例7	0. 13	0	<2
実施例8	0. 13	0	<2
実施例9	0. 13	0	<2
実施例 10	0. 13	•	<2
実施例 11	0. 12	0	<2
実施例 12	0. 12	0	<2
比較例1	0. 14	×	9
比較例2	0. 15	×	10
比較例3	0. 14	×	11
比較例4	0. 15	×	12
比較例5	0. 15	×	16
比較例6	0. 14	×	10

【0460】表4の結果から明らかなように、本発明に係る各実施例のポジ型レジスト組成物は、それぞれ満足すべき結果を得たが、各比較例のレジスト組成物は、特にレジストパターン形状及び引き置き時間による線幅変 50

動について不満足なものであった。

【0461】(実施例13~24、比較例7~10)下記表5に示すように、一般式(1)及び一般式(III)で示される構造単位を有する、酸の作用により分解し、

アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂、及び/ 又は、上記一般式(I)、一般式(II)及び一般式(II I)で示される構造単位を有する、酸の作用により分解 し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂に、 更に酸の作用により分解しアルカリ現像液に対する溶解 性が増大する化合物を添加した以外は実施例1~12と 同様にしてレジスト液を作製し、同様にして0.3μm

のレジスト膜を得た。

【0462】実施例1~12と同様の方法で解像力、レジストパターンプロファイル、真空チャンパー内での引き置きによる線幅変動について評価した結果を表6に示す。

【0463】 【表5】

	樹脂	溶解阻止化合物	酸兔生剂 (重量比)(g)	有機塩基	界面活性剂 (a)
実施例 13	B-13 (1.50)	I-1 (0.50)	D-1 (0.15)	E-2 (0.002)	F-1 (0.0035)
突施例 14	B-13 (1.50)	I-2 (0.50)	D-2 (0.15)	E-1 (0.002)	F-2 (0,0035)
実施例 15	B-13 (1.50)	i-3 (0.50)	D-1 (0.15)	E-2 (0.002)	F-1 (0.0035)
突施例 16	B-13 (1.50)	1–4 (0.50)	D-1 (0.15)	E-2 (0.002)	F-2 (0.0035)
突施例 17	B-14 (1.50)	1 −1 (0.50)	D-1/D-6 (6/4) (0.15)	E-1 (0.002)	F-1 (0.0035)
実施例 16	B-14 (1.50)	I-2 (0.50)	D-1 (0.15)	E-2 (0.002)	F-1 (0.0035)
突旋例 19	B-14 (1.50)	I-3 (0.50)	D-1/D-4 (6/4) (0.15)	E-1 (0.002)	F-1 (0.0035)
突遊例 20	B14 (1.50)	F-4 (0.50)	D-2 (0.15)	E-2 (0.002)	F-2 (0.0035)
突旋例 21	B-15 (1.50)	f-1 (0.50)	D-3 (0.15)	E-1 (0.002)	F-1 (0.0035)
実施例 22	B-15 (1.50)	1−2 (0.50)	D-1/D-5 (6/4) (0.15)	E-2 (D.DO2)	F-1 (0.0035)
突旋例 23	B-15 (1.50)	F-3 (0.50)	D-1 (0,15)	E-2 (0.002)	F-1 (0,0035)
実施例 24	B-15 (1.50)	I-4 (0.50)	D-1/D-6 (6/4) (0.15)	E-2 (0.002)	F-2 (0.0035)
比較例7	C-1 (1.50)	⊢1 (0.50)	D-1 (0.15)	E-2 (0.002)	F-1 (0,0035)
比較例8	C-2 (1.50)	⊢2 (0.50)	D-1 (0.15)	E-2 (0.002)	F-1 (0.0035)
比較例9	B-13 (1.50)	⊢1 (0.50)	D-1* (0.15)	E-2 (0,002)	F-1 (0.0035)
比較例 10	C-1 (1.50)	⊢1 (0.50)	D-1* (0.15)	E-2 (0.002)	F-1 (0.0035)

30

【0464】また、実施例に用いた溶解阻止化合物を以下に示す。

[0465]

【化157】

1-3
$$(H_3C)_3COOCO - C_2H_4 - C_2H_4 - C_2H_4 - OCOOC(CH_3)_3$$

$$OCOOC(CH_3)_3$$

[0466]

【表 6 】

表6					
	解像力	レジストバターン	線幅変動率		
	(µm)	形状	(96)		
実施例 13	0. 13	0	<2		
実施例 14	0. 13	0	<2		
実施例 15	0. 12	0	<2		
実施例 16	0. 13	0	<2		
実施例 17	0. 12	(<2		
実施例 18	0, 13	0	<2		
実施例 19	0. 12	0	<2		
実施例 20	0. 12	0	<2		
実施例 21	0. 13	©	<2		
実施例 22	0. 12	Ø	<2		
実施例 23	0. 12	0	<2		
実施例 24	0. 12	©	<2		
比较例7	0. 15	×	12		
比較例8	0. 15	×	14		
比較例9	0. 15	×	16		
比較例 10	0, 15	×	13		

【0467】表6の結果から明らかなように、本発明に係る各実施例のポジ型レジスト組成物は、特にレジストパターンプロファイル、真空チャンバー内での引き置きによる線幅変動についてより一層の改善がなされ、それぞれ満足すべき結果を得たが、各比較例のレジスト組成物は、特にレジストパターンプロファイル、真空チャンバー内での引き置きによる線幅変動について不満足なも

のであった。

[0468]

【発明の効果】本発明によれば、レジストパターンプロファイル、真空チャンバー内での引き置きによる線幅変動が改善された化学増幅型ポジ型レジスト組成物が提供される。

フロントページの続き

(72)発明者 白川 浩司 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写 真フイルム株式会社内

(72)発明者 髙橋 表 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写 真フイルム株式会社内

(72)発明者 藤森 亨 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写 真フイルム株式会社内 F ターム(参考) 2HO25 AAO3 AB16 ACO4 ACO5 ACO6 ADO3 BEOO BE10 BGOO CB17 CB41 FA17
4J100 ABO2R ABO7P ABO7Q ABO7R BAO2P BAO2R BAO3Q BAO4P BAO5R BA12P BA15P BA15R BA34R BCO3P BCO4P BCO4R BCO9P BC43P CAO4 CAO5

FA03 FA19 JA38

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.